

A-D変換器とD-A変換器

現実の世界と理想の世界

A-D変換器とD-A変換器の概要

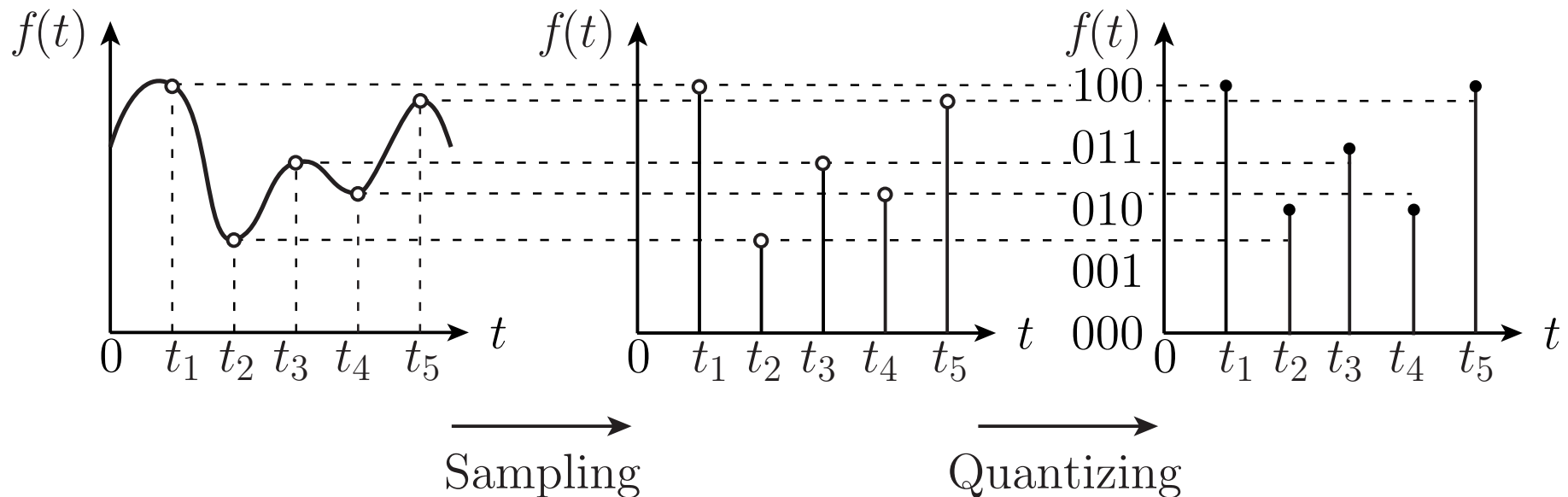
アナログ信号: 連続振幅 (連続時間)

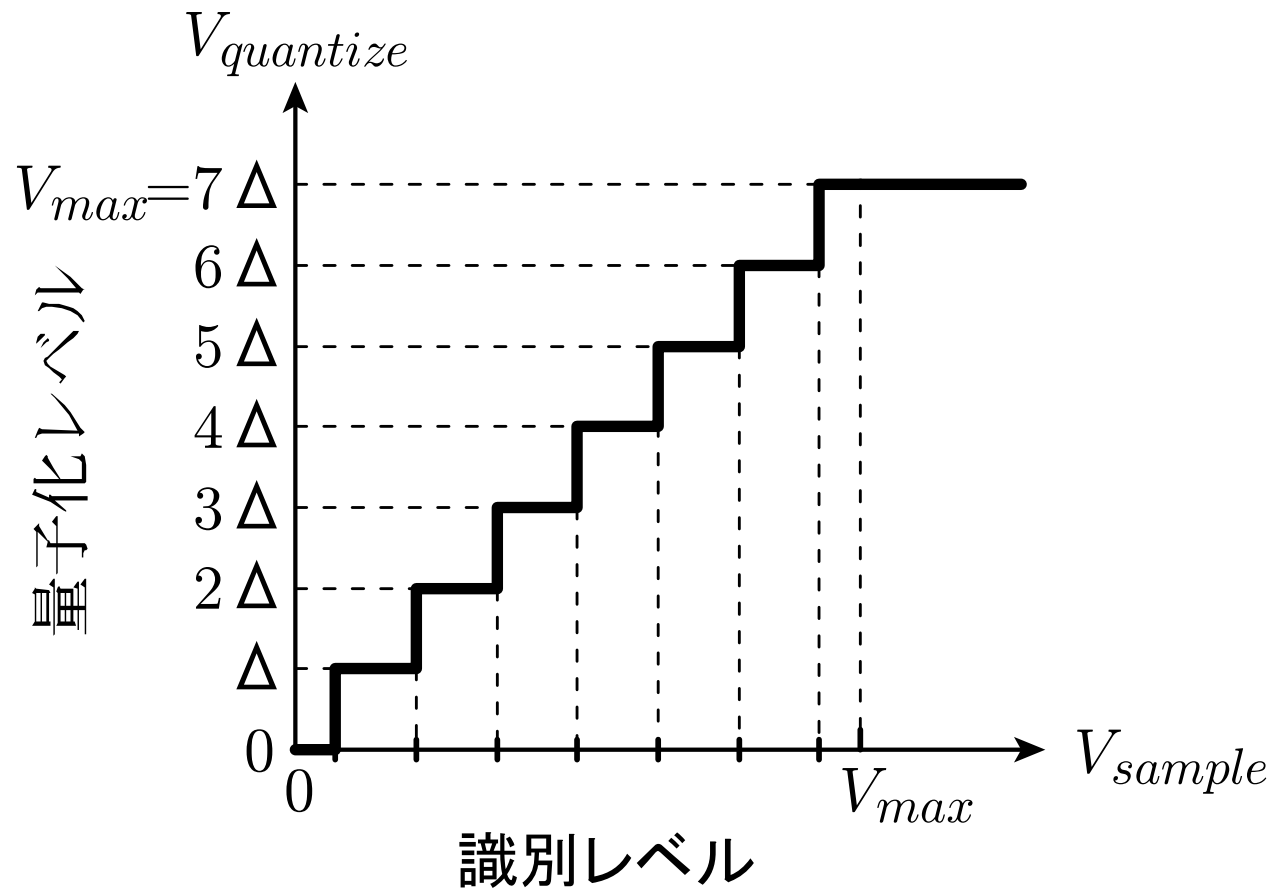
デジタル信号: 離散時間, 離散振幅 (0, 1の数値列)

標本化

量子化

符号化





V_{sample} : 標本化したアナログ信号

$V_{quantize}$: V_{sample} を量子化した信号

Δ : 量子化ステップ

V_{max} : フルスケール

$$\Delta = \frac{V_{max}}{2^n - 1}$$

$$V_{quantize} = (b_n \times 2^{n-1} + b_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + b_2 \times 2 + b_1) \Delta$$

$V_{quantize} \rightarrow b_n b_{n-1} \dots b_2 b_1$: 2進数表示 (符号化の1種)

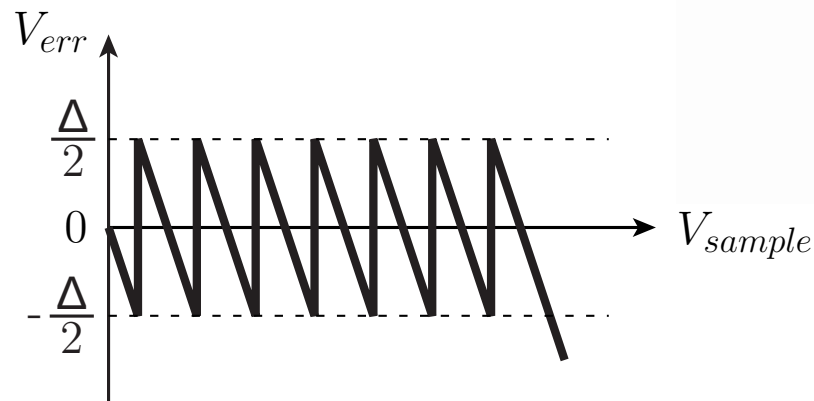
nビットのデジタル信号

b_n : Most Significant Bit (MSB)

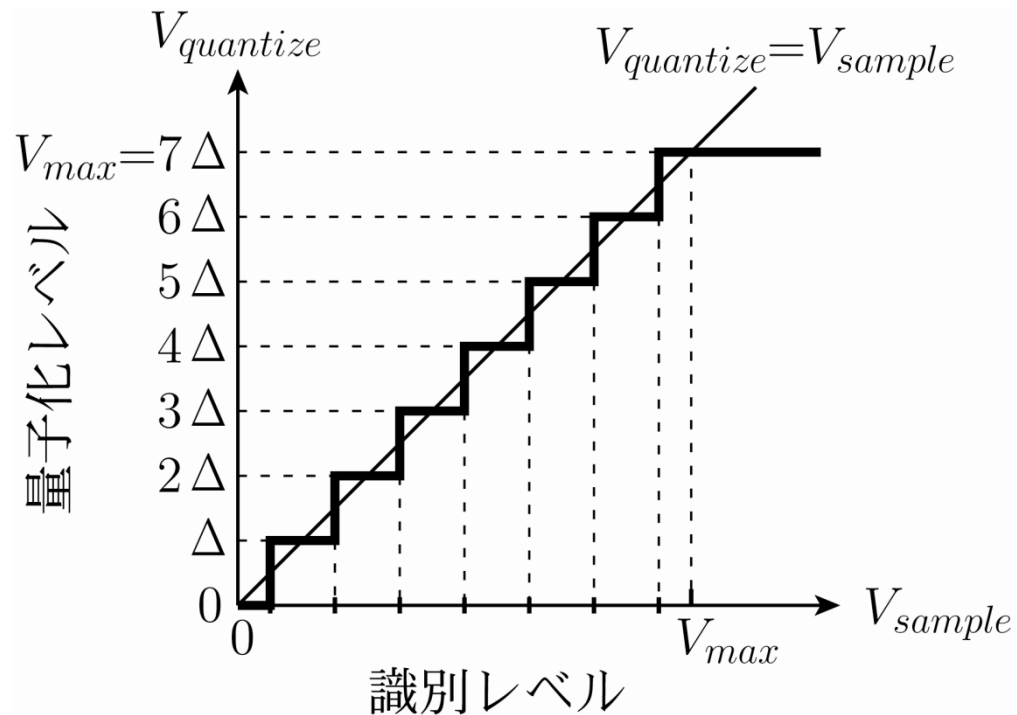
b_1 : Least Significant Bit (LSB) $(\Delta = 1\text{LSB})$

変換器の評価

量子化雑音



$$p(V_{err}) = \frac{1}{\Delta} \quad (|V_{err}| \leq \frac{\Delta}{2})$$



$$P_N = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} p(V_{err}) V_{err}^2 dV_{err}$$

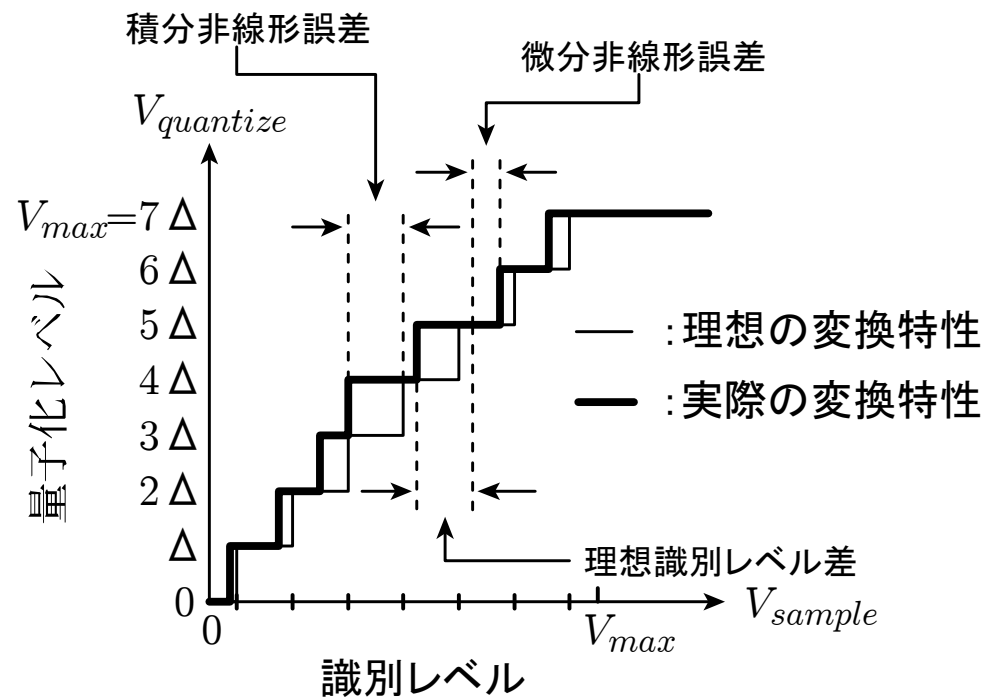
$$= \frac{1}{\Delta} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} V_{err}^2 dV_{err}$$

$$= \frac{\Delta^2}{12}$$

信号電力

$$P_S = \frac{1}{T} \int_0^T \left\{ \frac{V_{max}}{2} \sin(2\pi \frac{t}{T}) \right\}^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_{max}^2}{4} \cdot \frac{1 - \cos(4\pi \frac{t}{T})}{2} dt$$
$$= \frac{V_{max}^2}{8} \quad \left(\Delta = \frac{V_{max}}{2^n - 1} \right)$$

$$SNR_{max} = 10 \log \frac{P_S}{P_N} = 10 \log \frac{\frac{\{(2^n - 1)\Delta\}^2}{8}}{\frac{12}{\Delta^2}} = 10 \log \left\{ \frac{3}{2} (2^n - 1)^2 \right\}$$
$$= 10 \log \frac{3}{2} + 10 \log (2^n - 1)^2 \approx 10 \log \frac{3}{2} + 10 \log 2^{2n}$$
$$\approx 10 \log \frac{3}{2} + 20n \log 2 \approx 6.02n + 1.76 \text{ dB}$$



静的特性

積分線形性

微分線形性

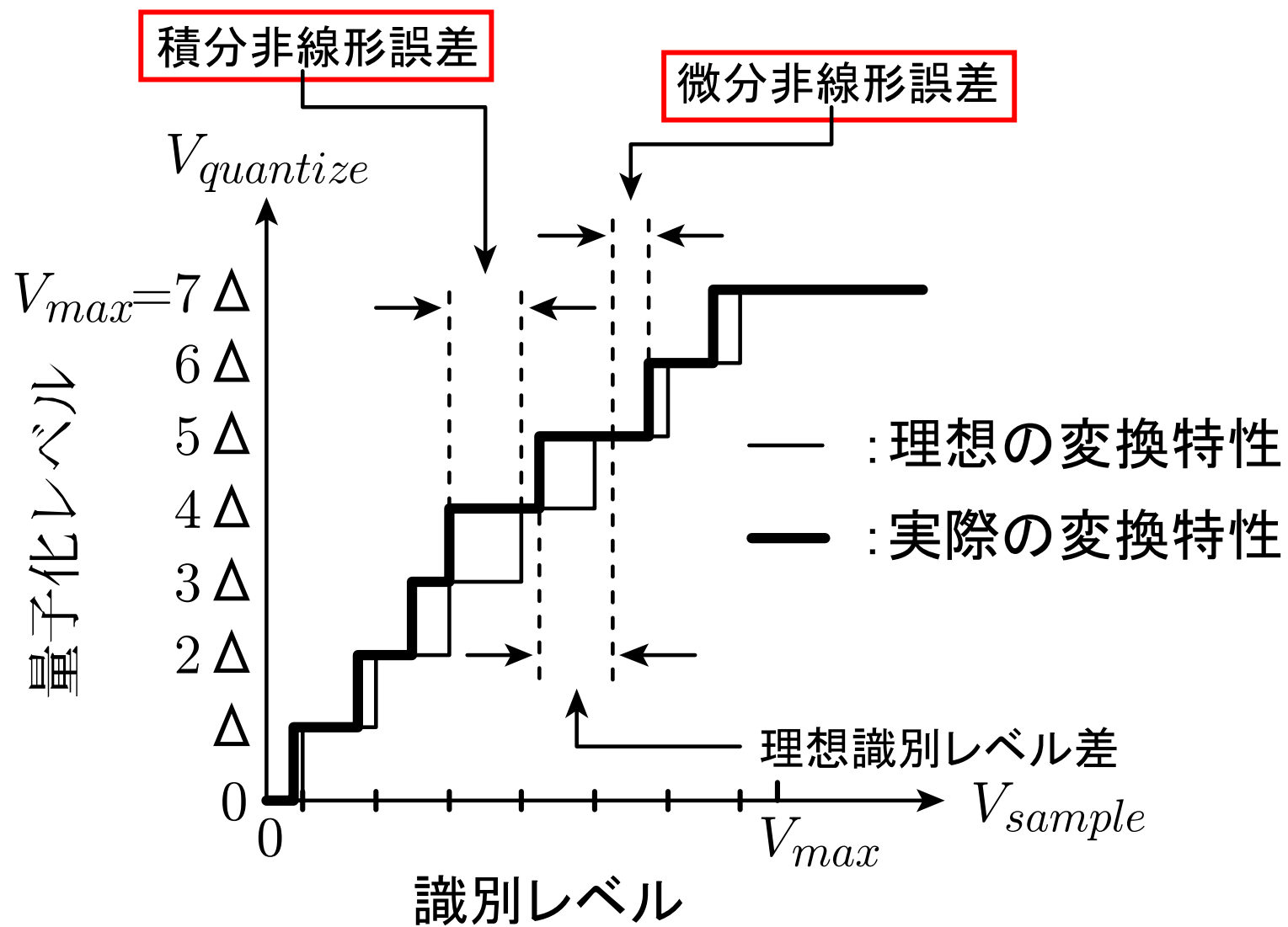
単調性

利得誤差

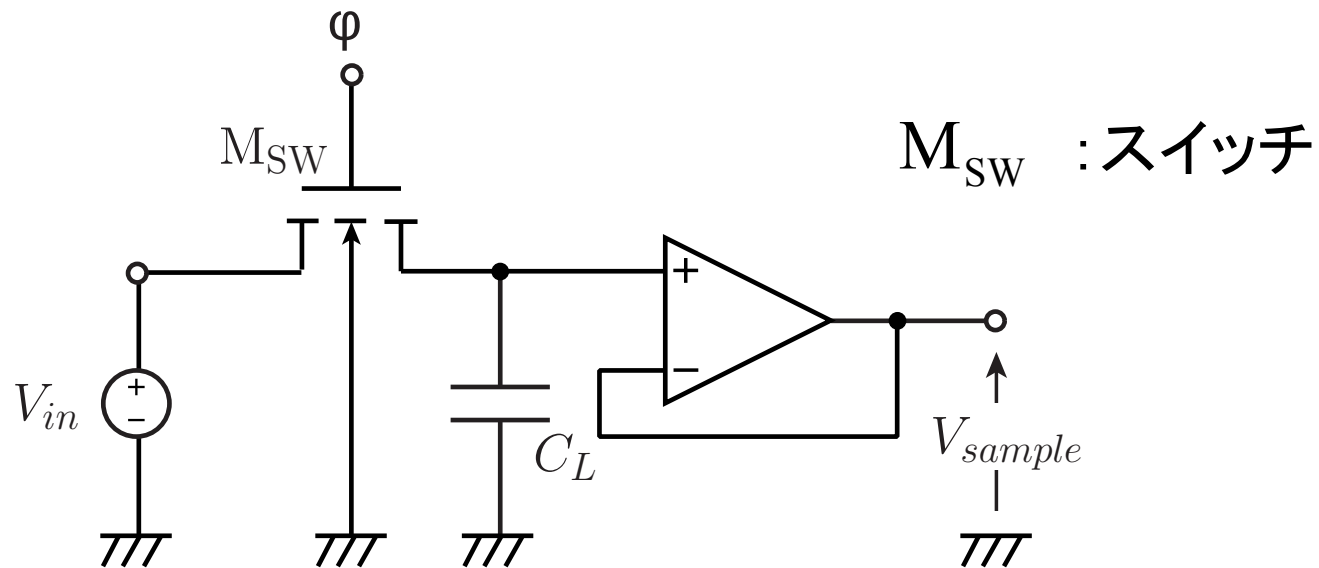
オフセット

動的特性

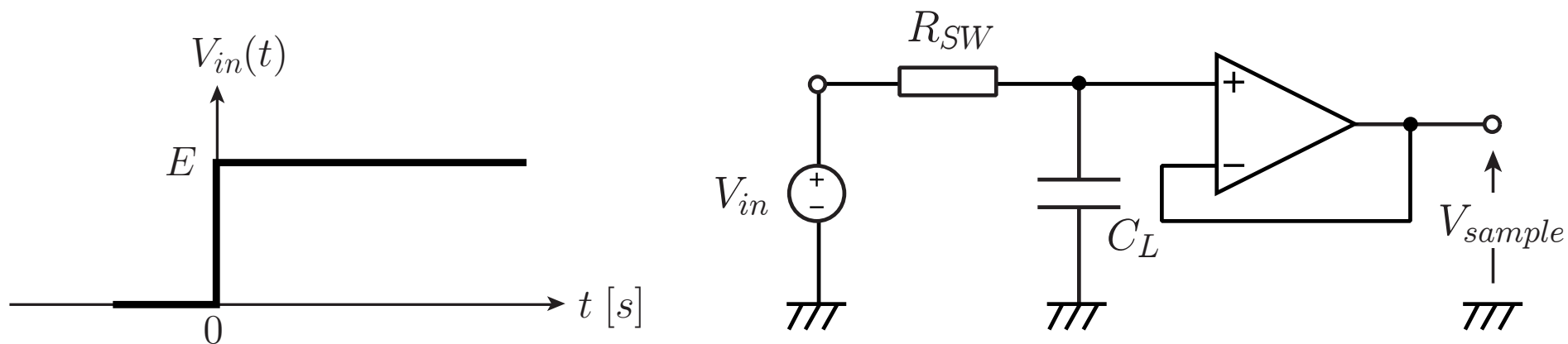
変換速度(セトリングタイム)



標本化回路の構成



M_{SW} の等価抵抗： R_{SW}



$$\frac{V_{in} - V_{sample}}{R_{SW}} = C_L \frac{dV_{sample}}{dt}$$

$t \geq 0$ のとき

$$\frac{E}{C_L R_{SW}} = \frac{dV_{sample}}{dt} + \frac{V_{sample}}{C_L R_{SW}}$$

V_{sample} の特殊解は

$$V_{sample} = E$$

$$\frac{dV_{sample}}{dt} + \frac{V_{sample}}{C_L R_{SW}} = 0 \text{ の一般解は}$$

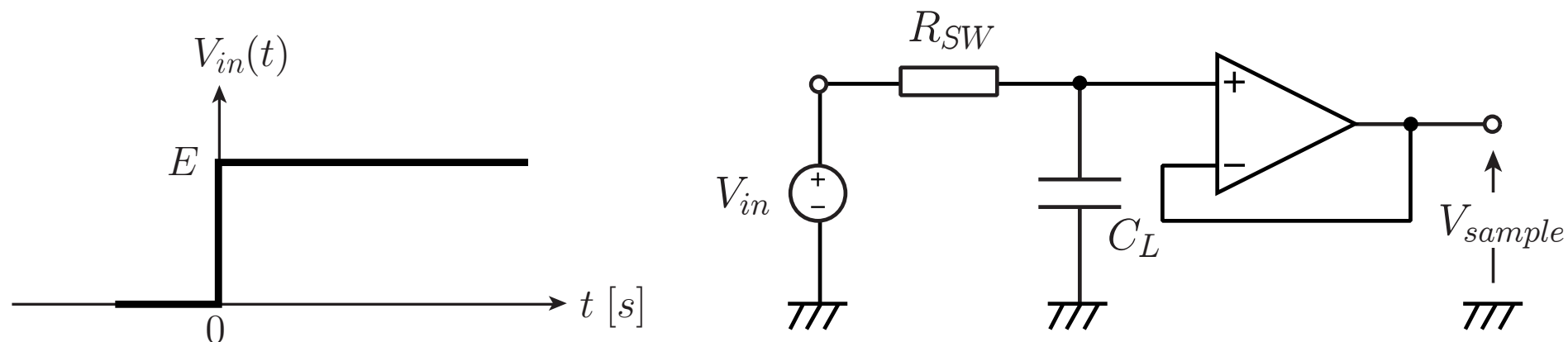
$$V_{sample} = \pm A \exp\left(\frac{-t}{C_L R_{SW}}\right) \quad \text{ただし, } A \text{ は正の定数}$$

したがって, V_{sample} は

$$V_{sample} = E \pm A \exp\left(\frac{-t}{C_L R_{SW}}\right)$$

$t=0$ のとき C_L に蓄えられている電荷を零と仮定

$$V_{sample} = E \left\{ 1 - \exp\left(\frac{-t}{C_L R_{SW}}\right) \right\}$$



$$V_{sample} = E \left\{ 1 - \exp\left(\frac{-t}{C_L R_{SW}}\right) \right\} \text{なので}$$

t_{hold} 秒後の V_{sample}

$$V_{sample} = \left\{ 1 - \exp\left(\frac{-t_{hold}}{C_L R_{SW}}\right) \right\} E$$

$$t_{hold} \gg C_L R_{SW} \rightarrow V_{sample} \approx V_{in}$$

$$t_{hold} \gg C_L R_{SW}$$

C_L : 寄生容量により定まる下限値

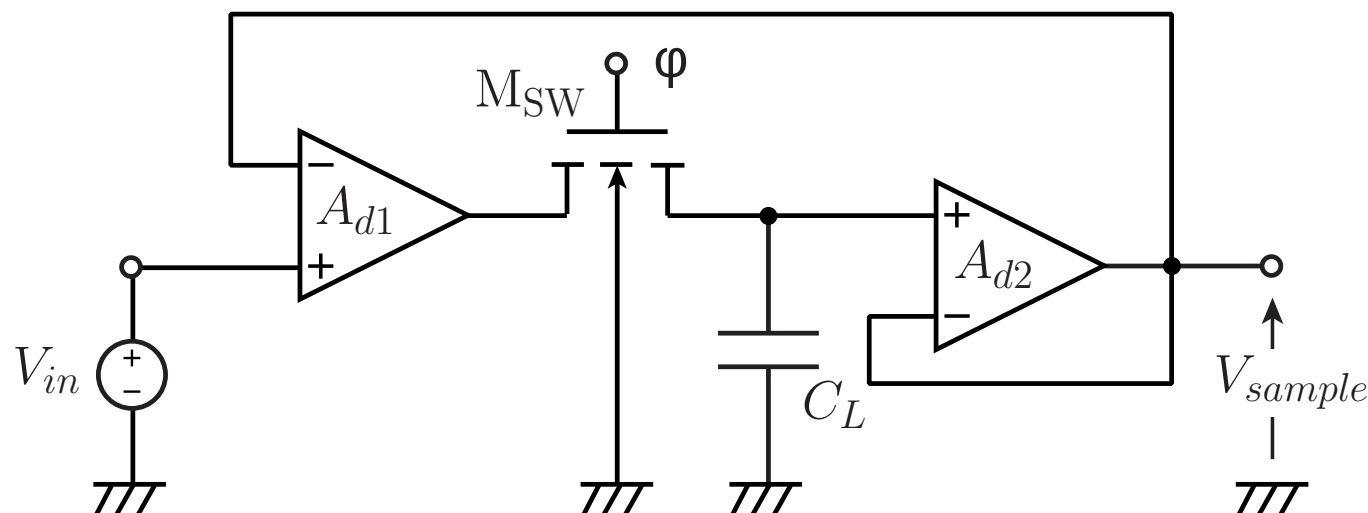
R_{SW} : 許容できるスイッチ M_{SW} の面積からの下限値

C_L の増加



回路的な改善

改良した標本化回路



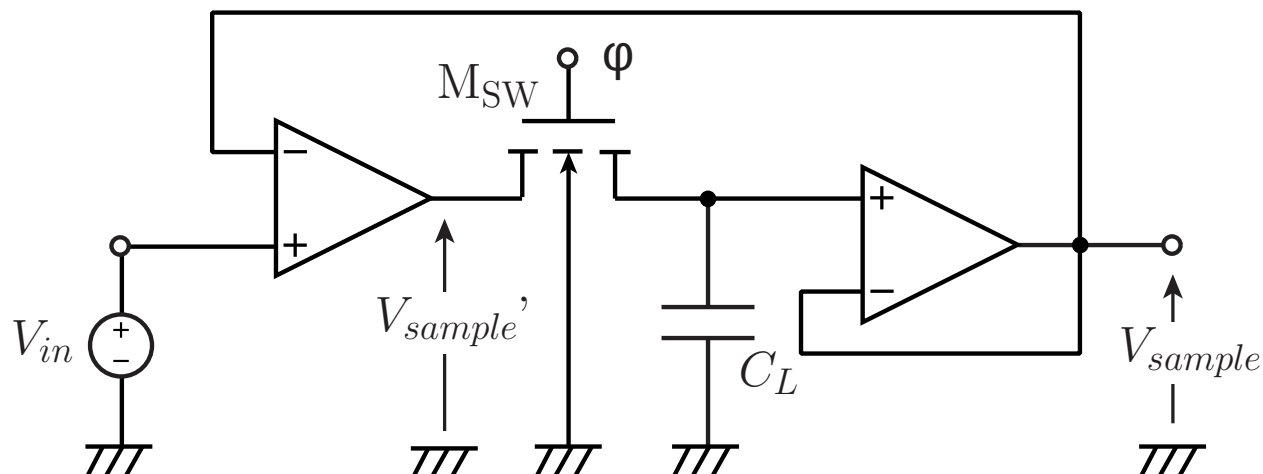
標本化回路(2)

t_{hold} 秒後の V_{sample}

$$V_{sample} = \frac{A_{d1}A_{d2}}{1 + A_{d2} + A_{d1}A_{d2}} \left[1 - \exp \left\{ \frac{-(1 + A_{d2} + A_{d1}A_{d2})t_{hold}}{(1 + A_{d2})C_L R_{SW}} \right\} \right] E$$

$$C_L R_{SW} \rightarrow (1 + A_{d2})C_L R_{SW} / (1 + A_{d2} + A_{d1}A_{d2})$$

改良した標本化回路の問題点

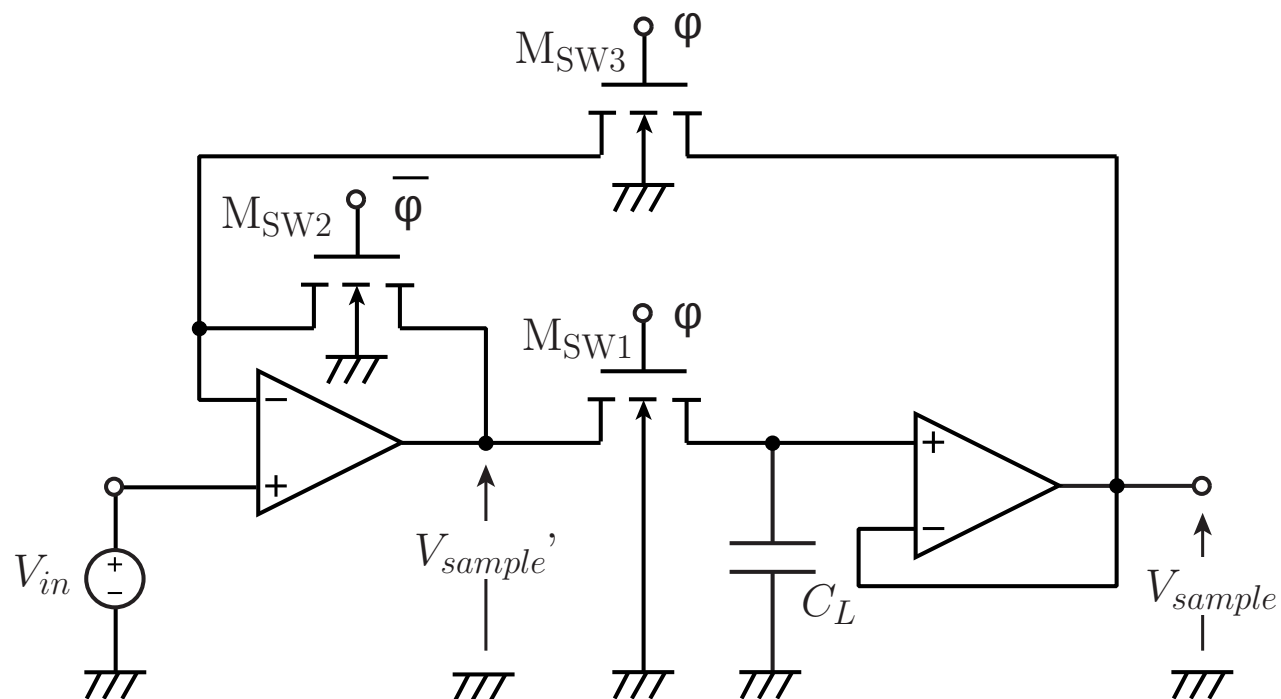


$$V_{sample}' = V_{DD} \text{ または } -V_{SS}$$



V_{sample}' が V_{in} になるまでの時間が大

さらに改良した標本化回路



標本化回路(3)

$$V_{sample}' = V_{in}$$

D-A変換器の構成

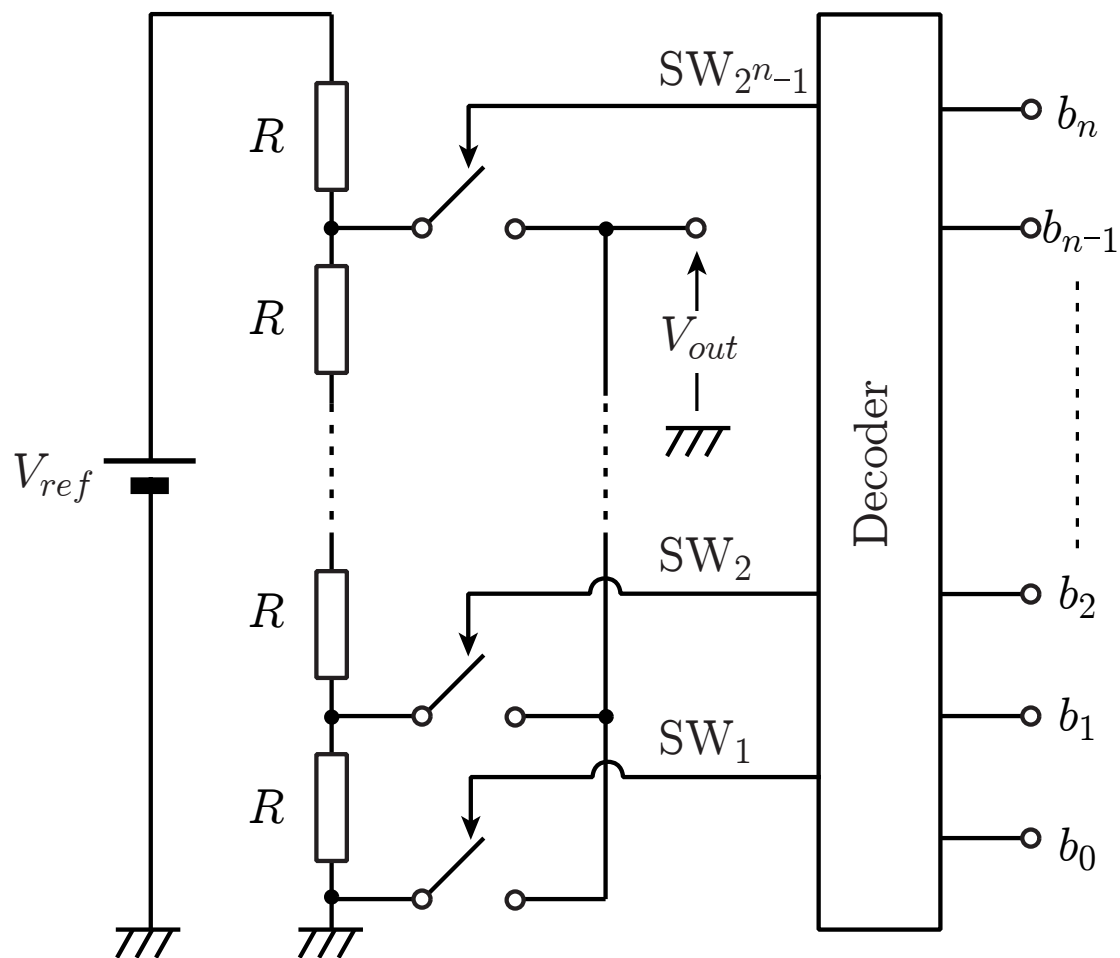
抵抗切り替え型構成

電流源切り替え型

容量切り替え型

その他

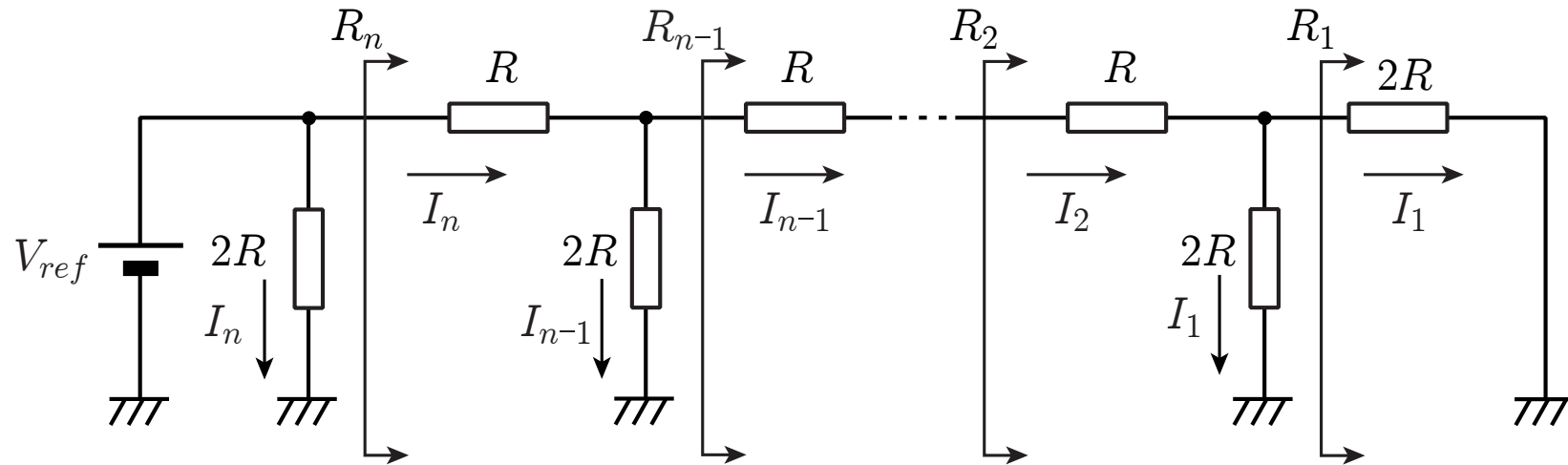
抵抗ストリング構成



$$V_{out} = \frac{i}{2^n} V_{ref} \quad (i = 0 \text{ to } 2^{n-1} + 1)$$

抵抗の面積: $(2^n - 1)R$

R-2R型構成



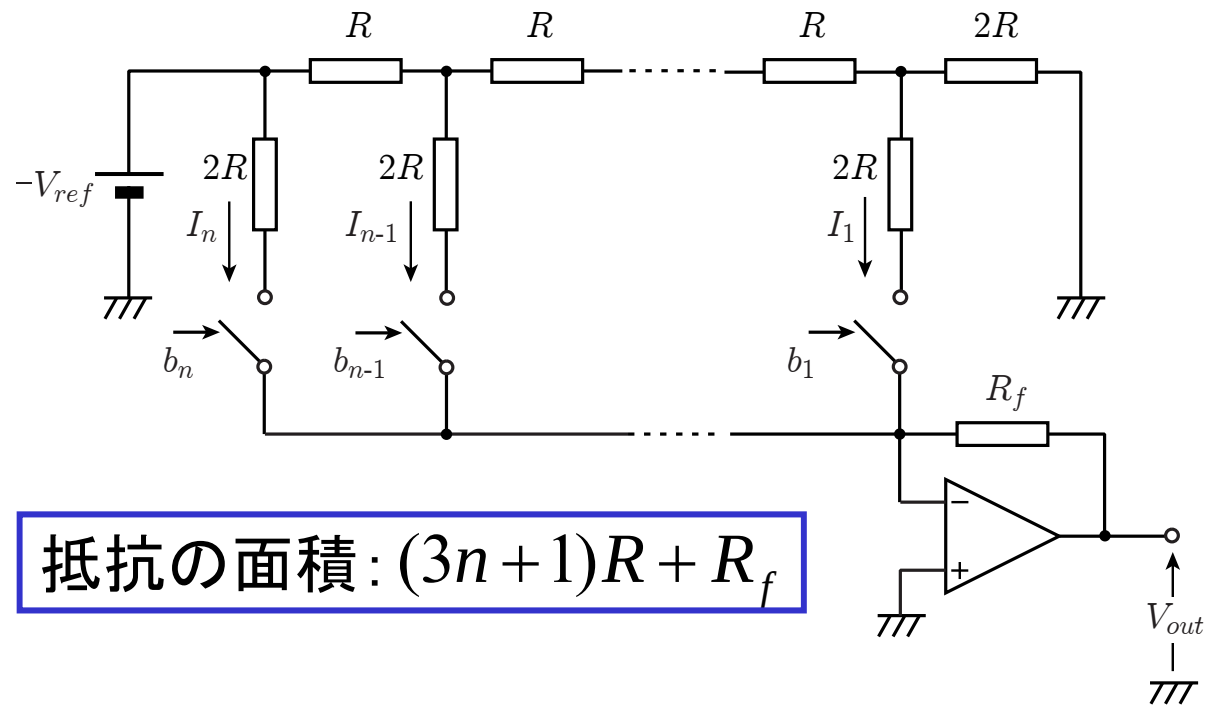
$$R_i=2R \ (i=1 \text{ to } n)$$



$$I_{i-1} = \frac{1}{2} I_i \quad (i=2 \text{ to } n)$$

$$I_n = \frac{V_{ref}}{2R}$$

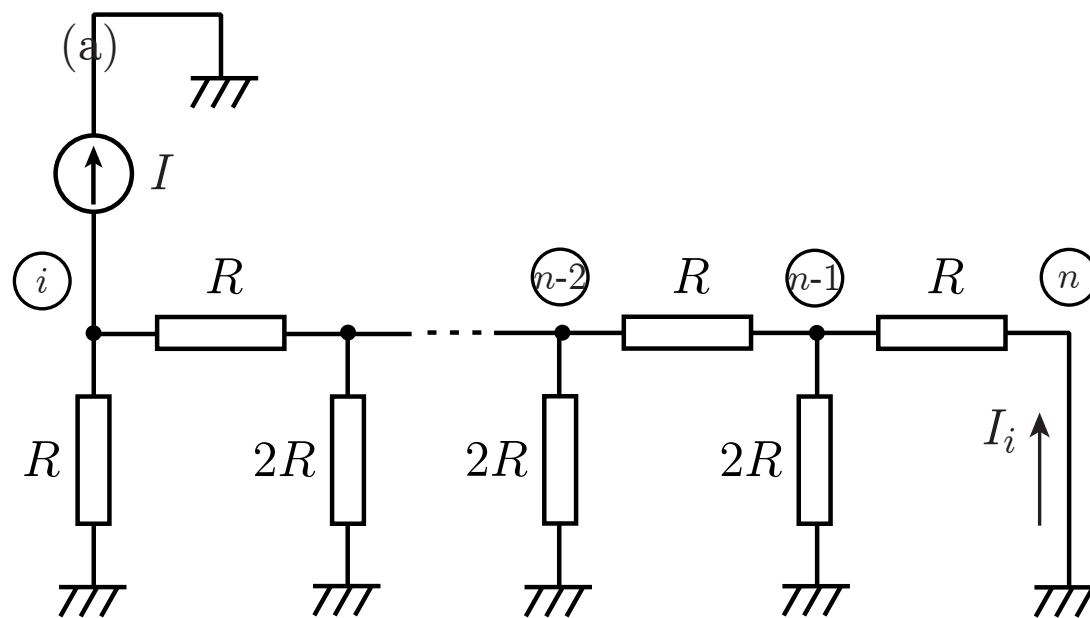
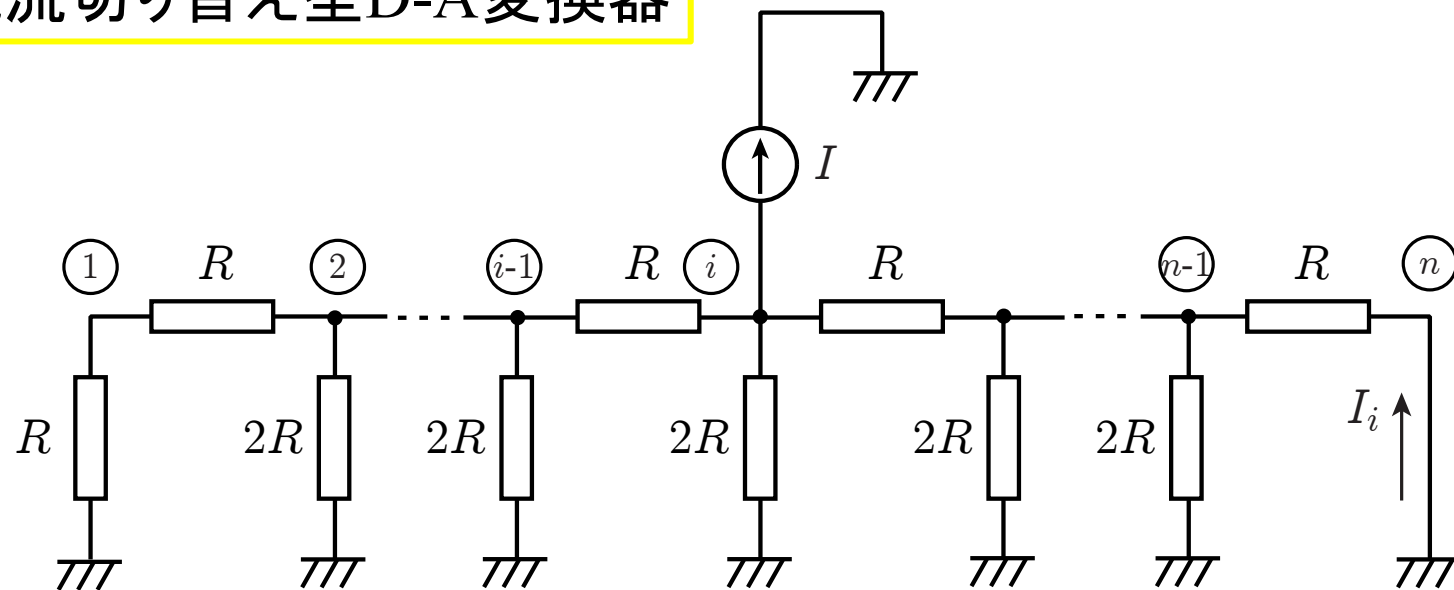
$$V_{quantize} = (b_n \times 2^{n-1} + b_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + b_2 \times 2 + b_1) \Delta$$



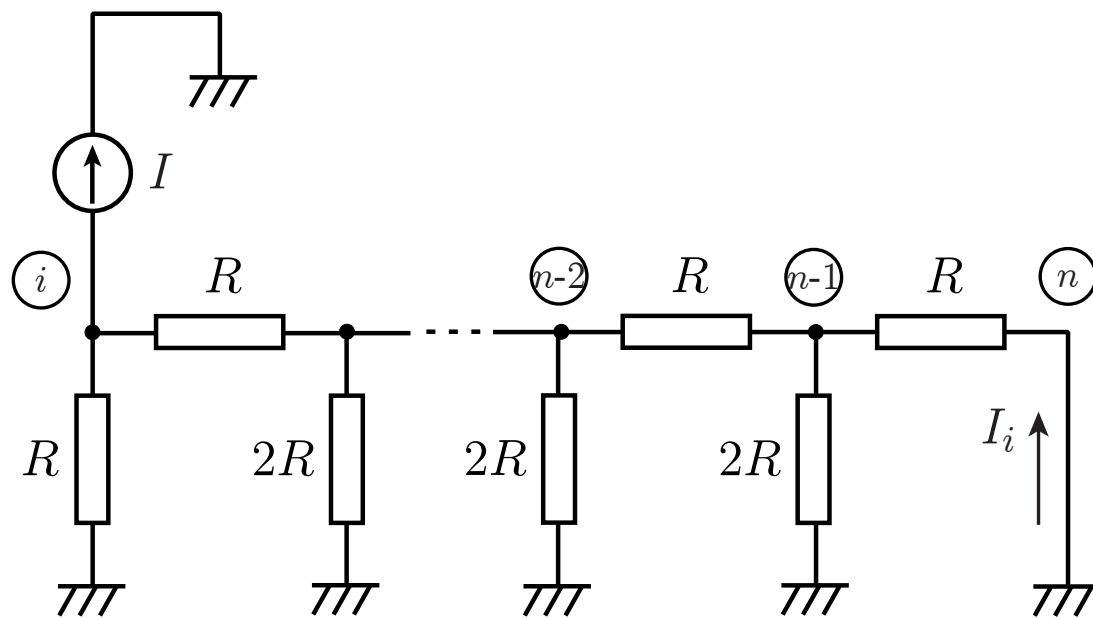
抵抗の面積: $(3n + 1)R + R_f$

$$\begin{aligned} V_{out} &= -(b_n \times I_n + b_{n-1} \times I_{n-1} + \dots + b_2 \times I_2 + b_1 \times I_1) R_f \\ &= -(b_n \times I_n + b_{n-1} \times 2^{-1} I_n + \dots + b_2 \times 2^{-(n-2)} I_n + b_1 \times 2^{-(n-1)} I_n) R_f \\ &= (b_n + b_{n-1} \times 2^{-1} + \dots + b_2 \times 2^{-(n-2)} + b_1 \times 2^{-(n-1)}) \frac{R_f}{2R} V_{ref} \\ &= (b_n \times 2^{n-1} + b_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + b_2 \times 2 + b_1) \frac{R_f}{2^n R} V_{ref} \end{aligned}$$

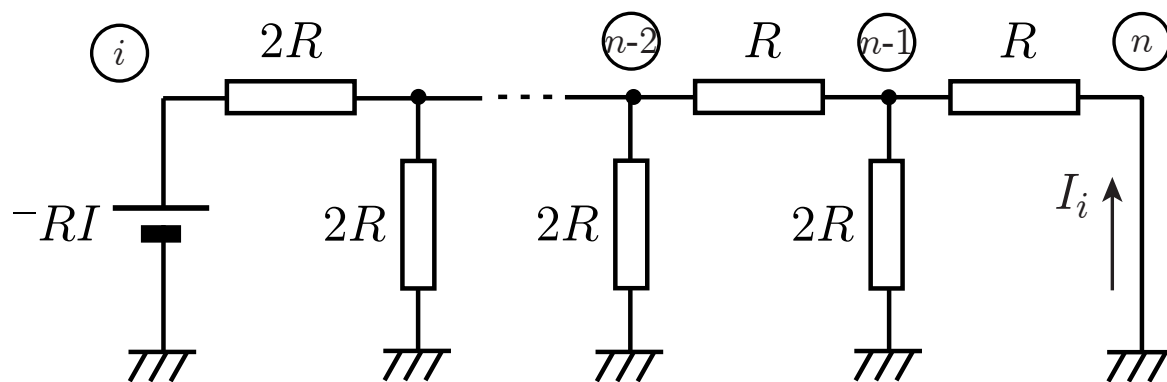
電流切り替え型D-A変換器



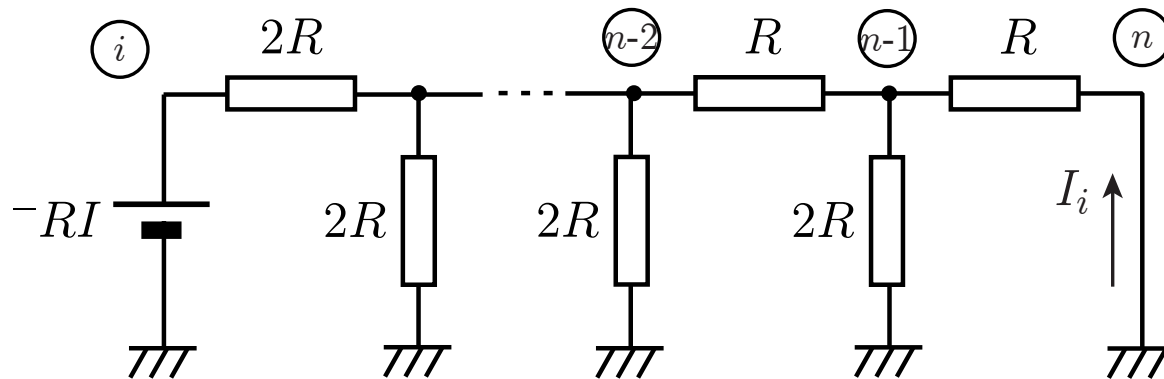
(b)



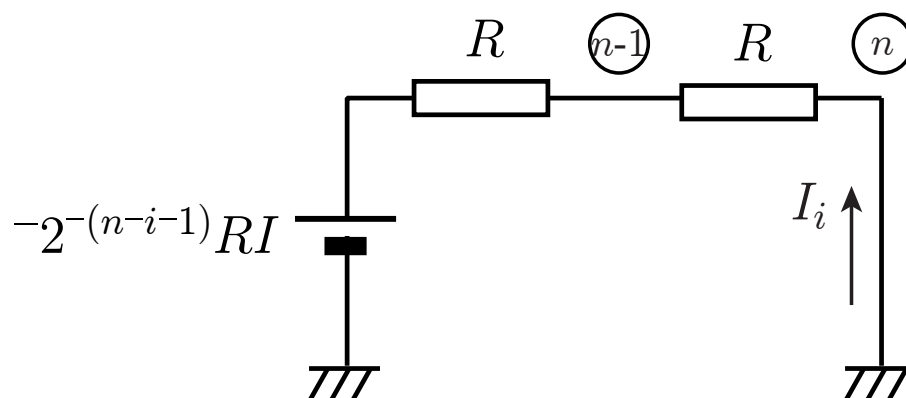
(b)



(c)



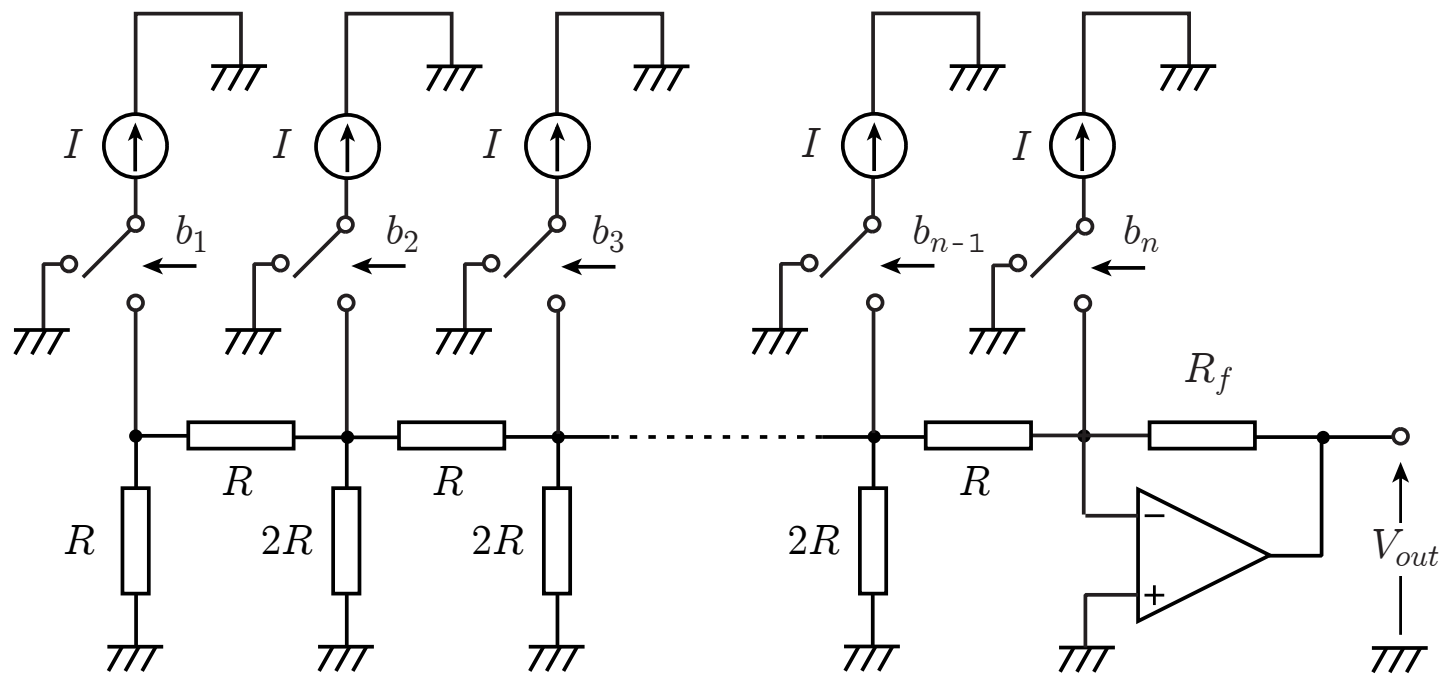
(c)



(d)

$I_n = \frac{V_{ref}}{2R}$ とすると

$$I_i = 2^{-(n-i)} \frac{V_{ref}}{R} \quad (i=1 \text{ to } n)$$

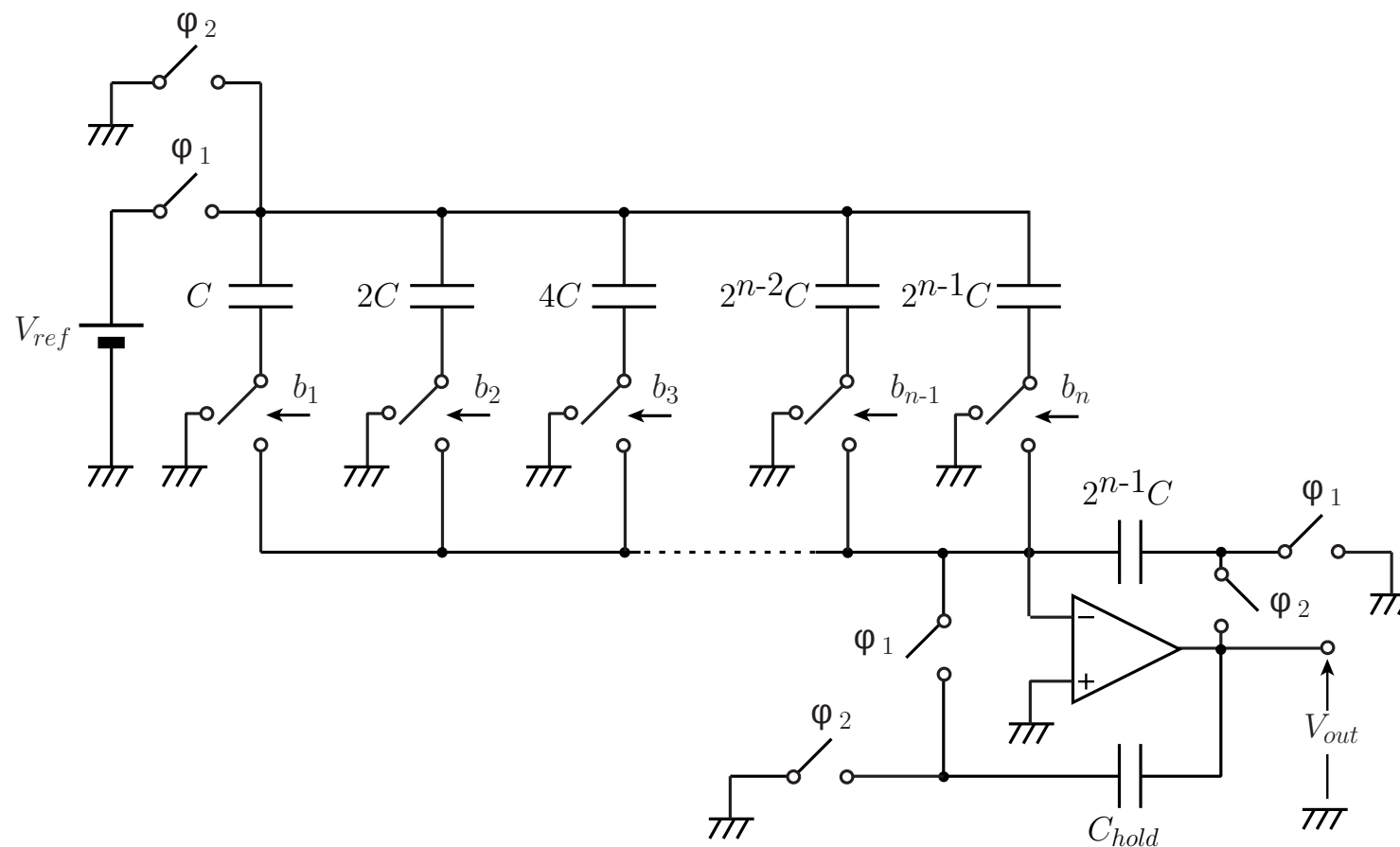


$$V_{out} = (b_n \times 2^{n-1} + b_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + b_2 \times 2 + b_1) \frac{R_f}{2^{n-1} R} V_{ref}$$

抵抗の面積: $(3n-1)R + R_f$

スイッチによる電圧降下の影響を受けない

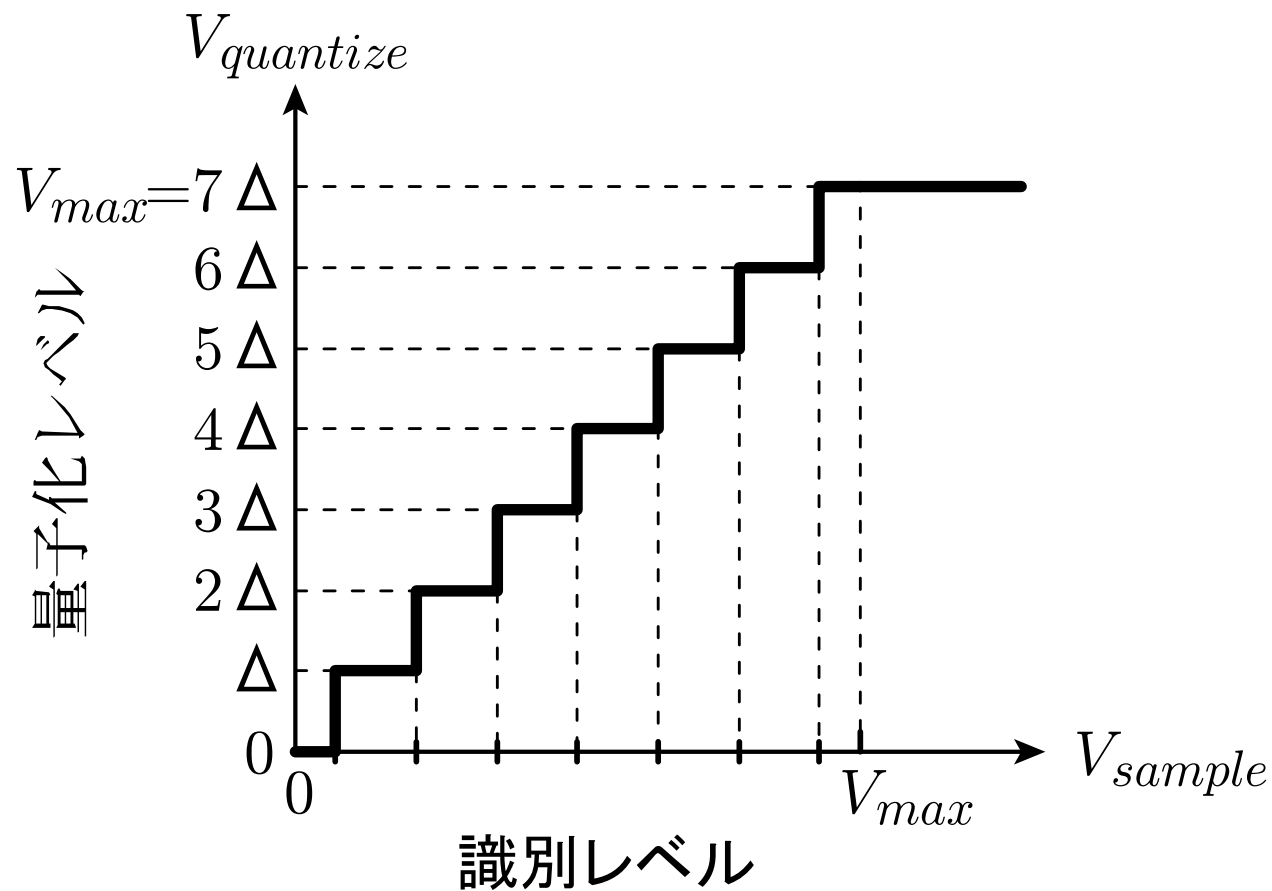
容量切り替え型



スイッチの電圧降下による誤差

MOSプロセスにより容易に実現

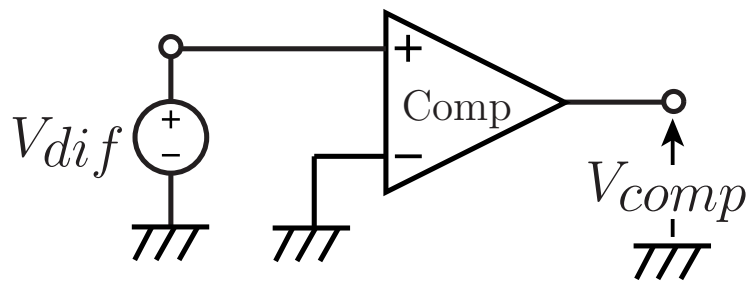
A-D変換器の構成



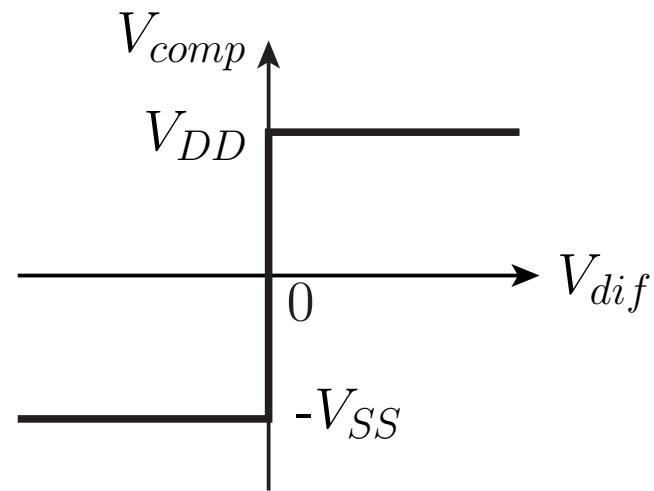
標本値を量子化→比較

比較器の構成

比較器の記号と理想特性

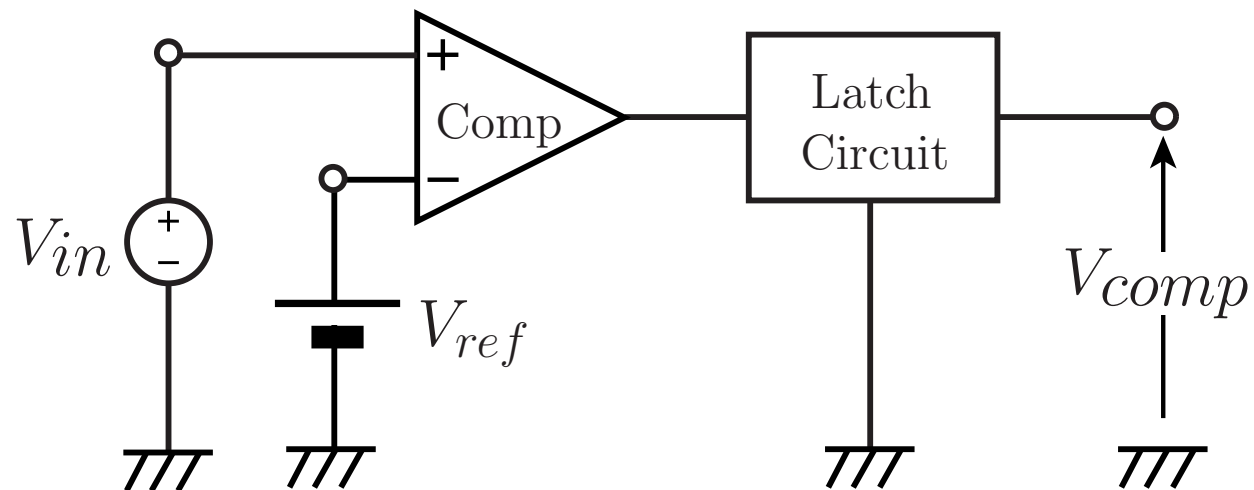


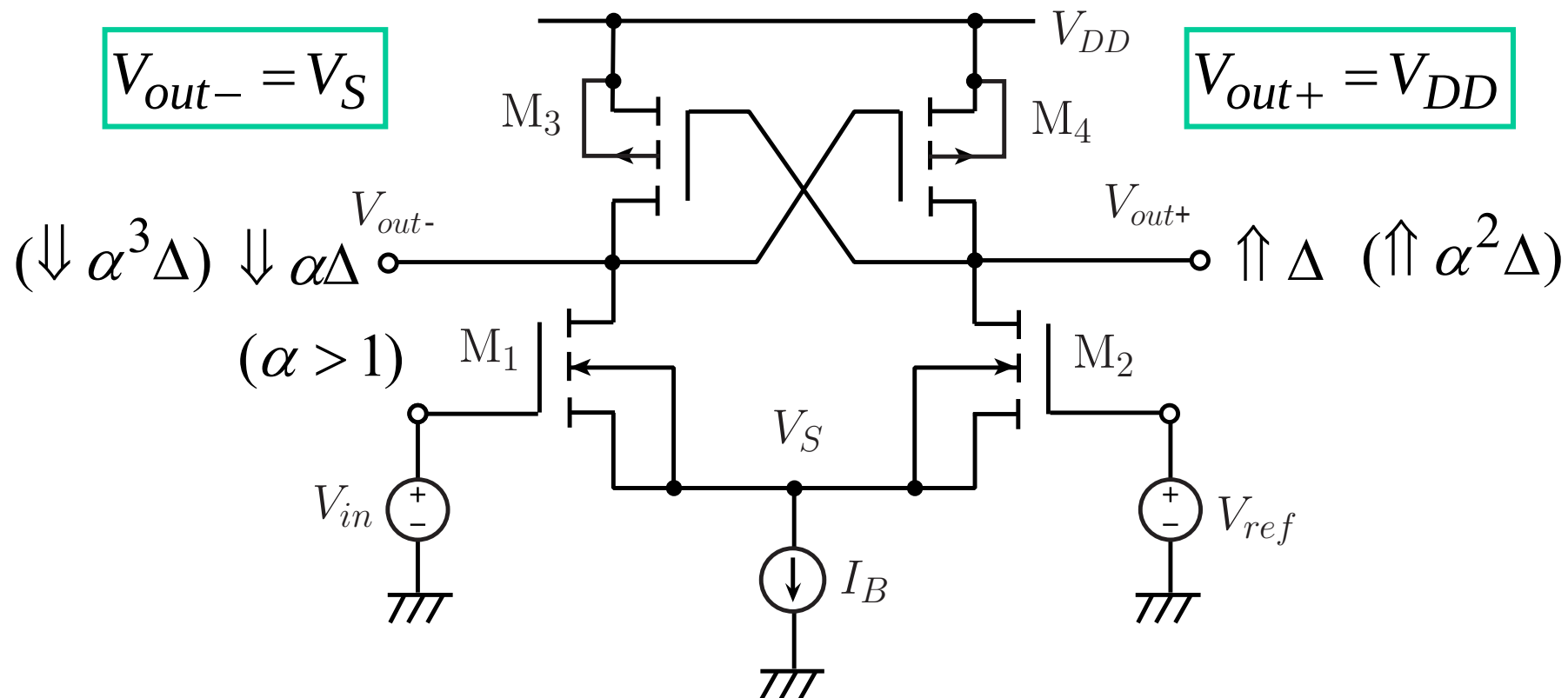
(a)



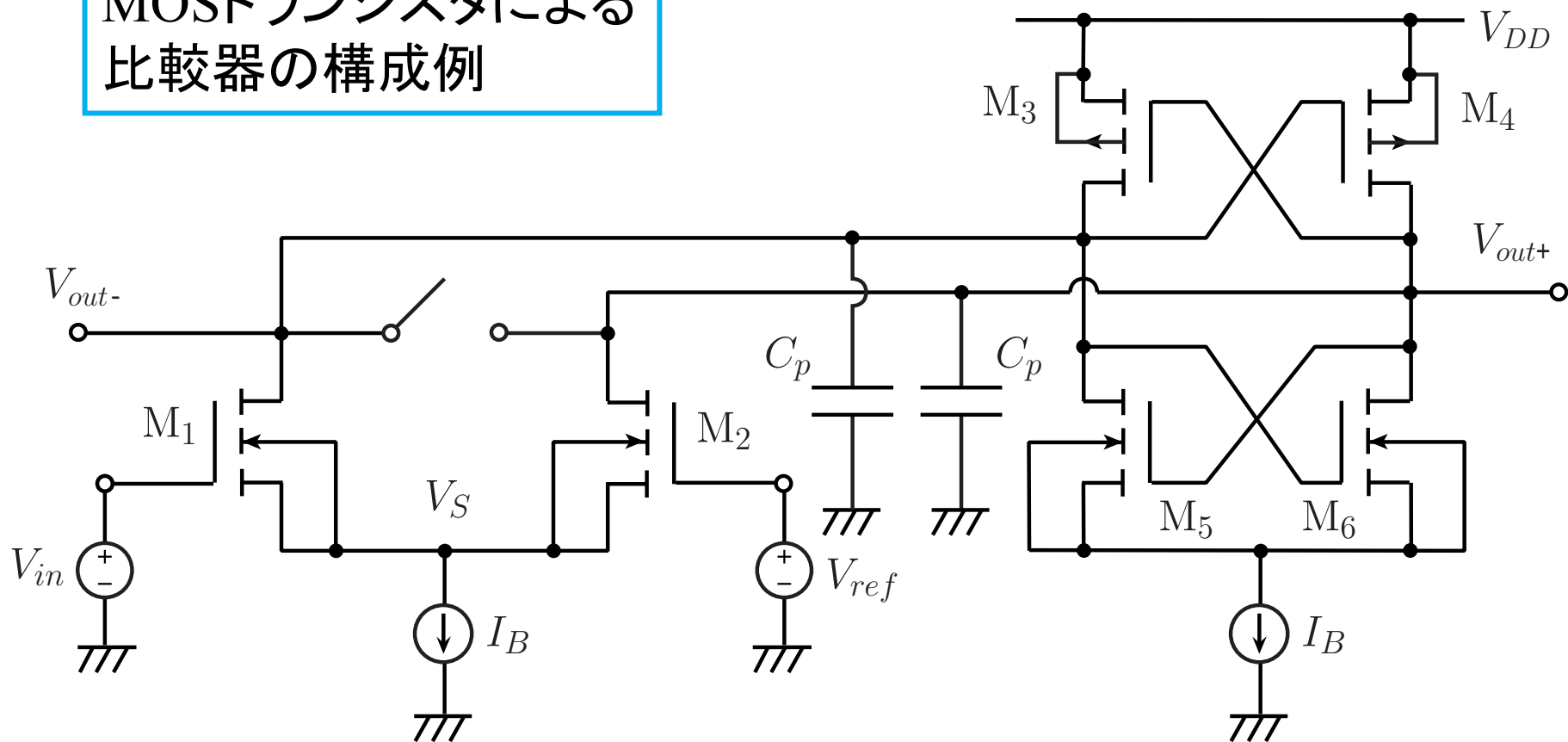
(b)

比較器の動作原理

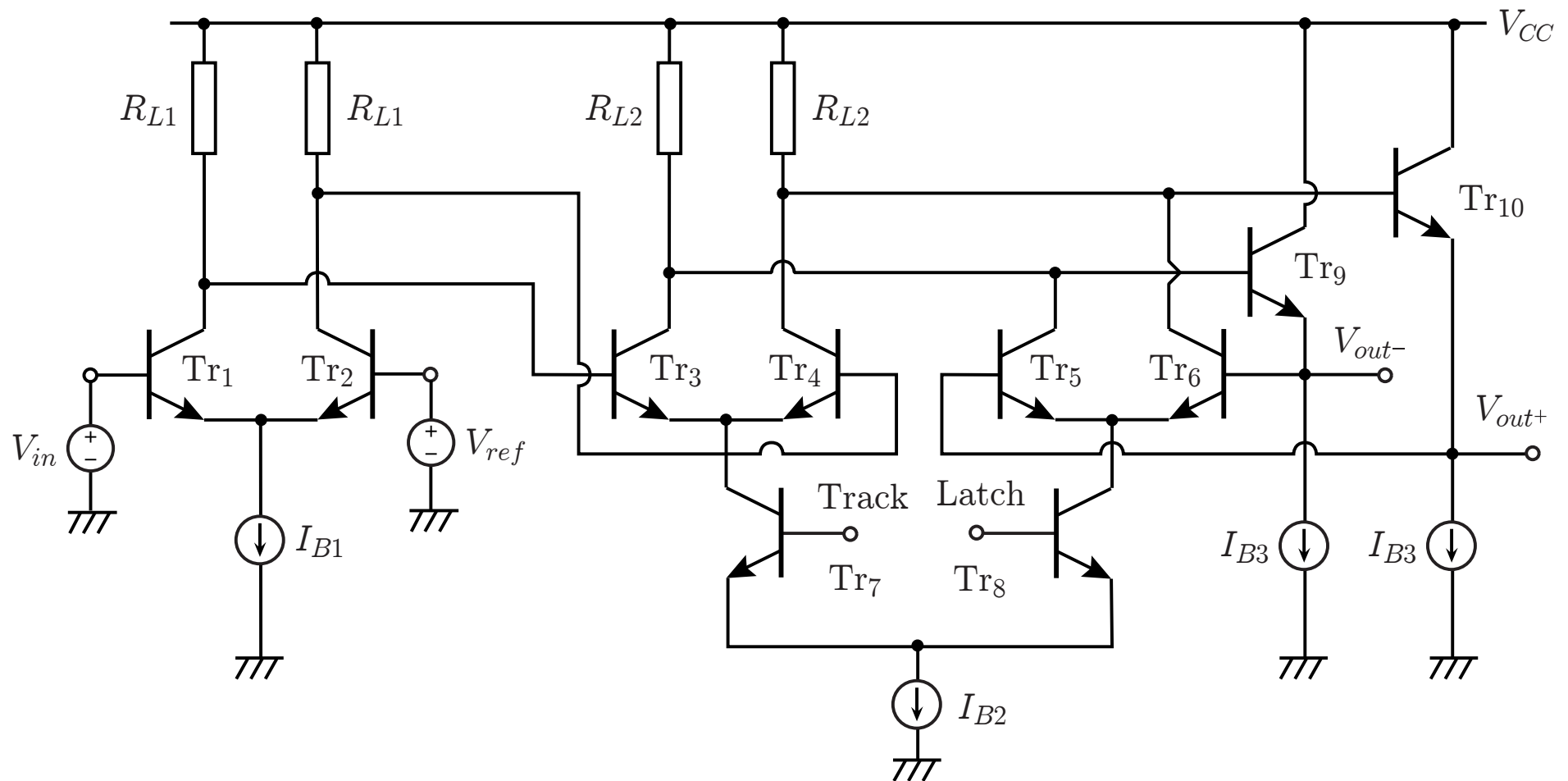




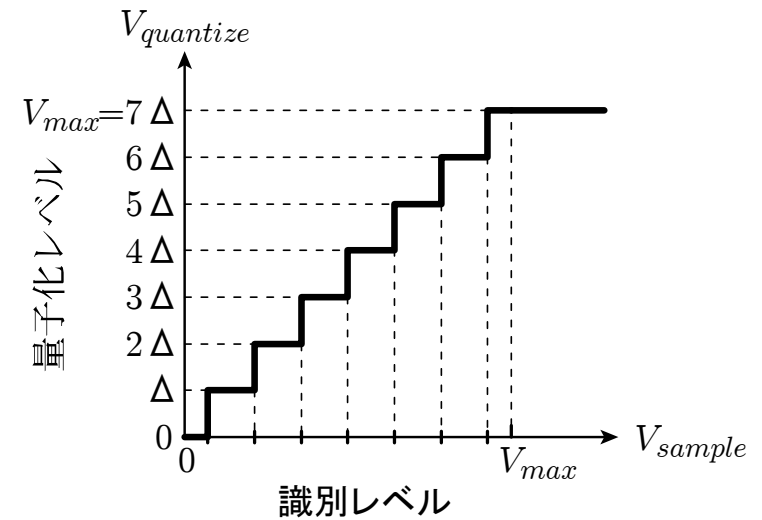
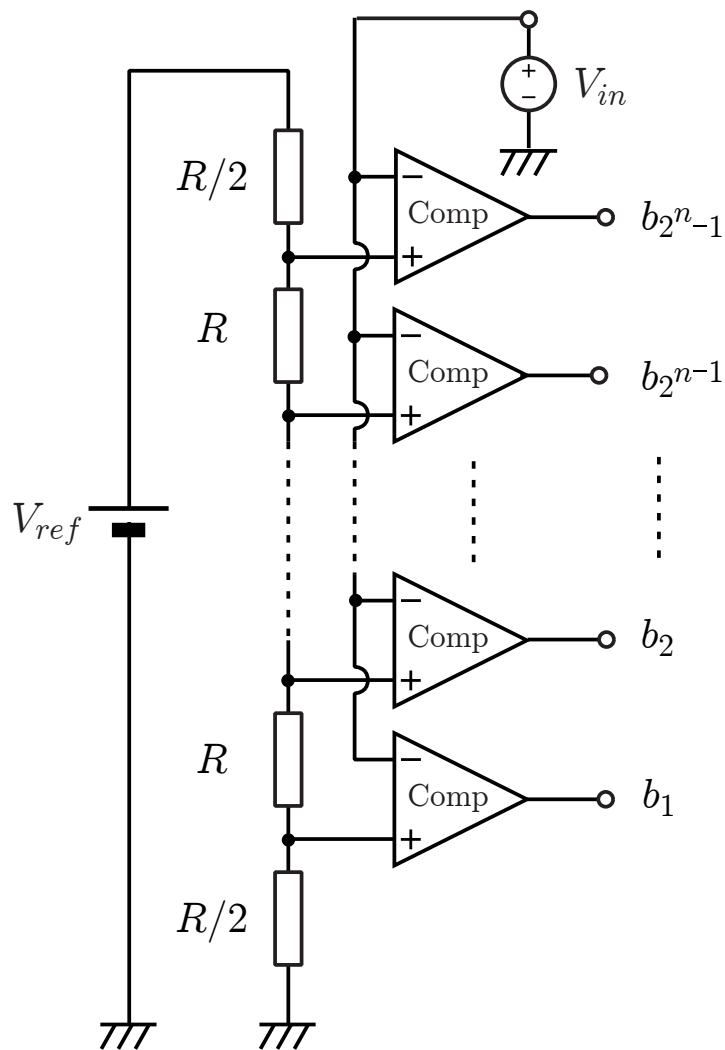
MOSTランジスタによる 比較器の構成例



バイポーラトランジスタによる 比較器の構成例



フラッシュ型構成

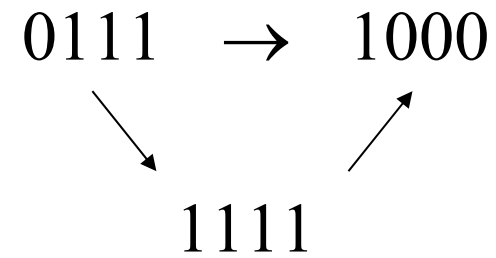


サーモメータコード

高速動作

素子数の指数的増加

グリッチ

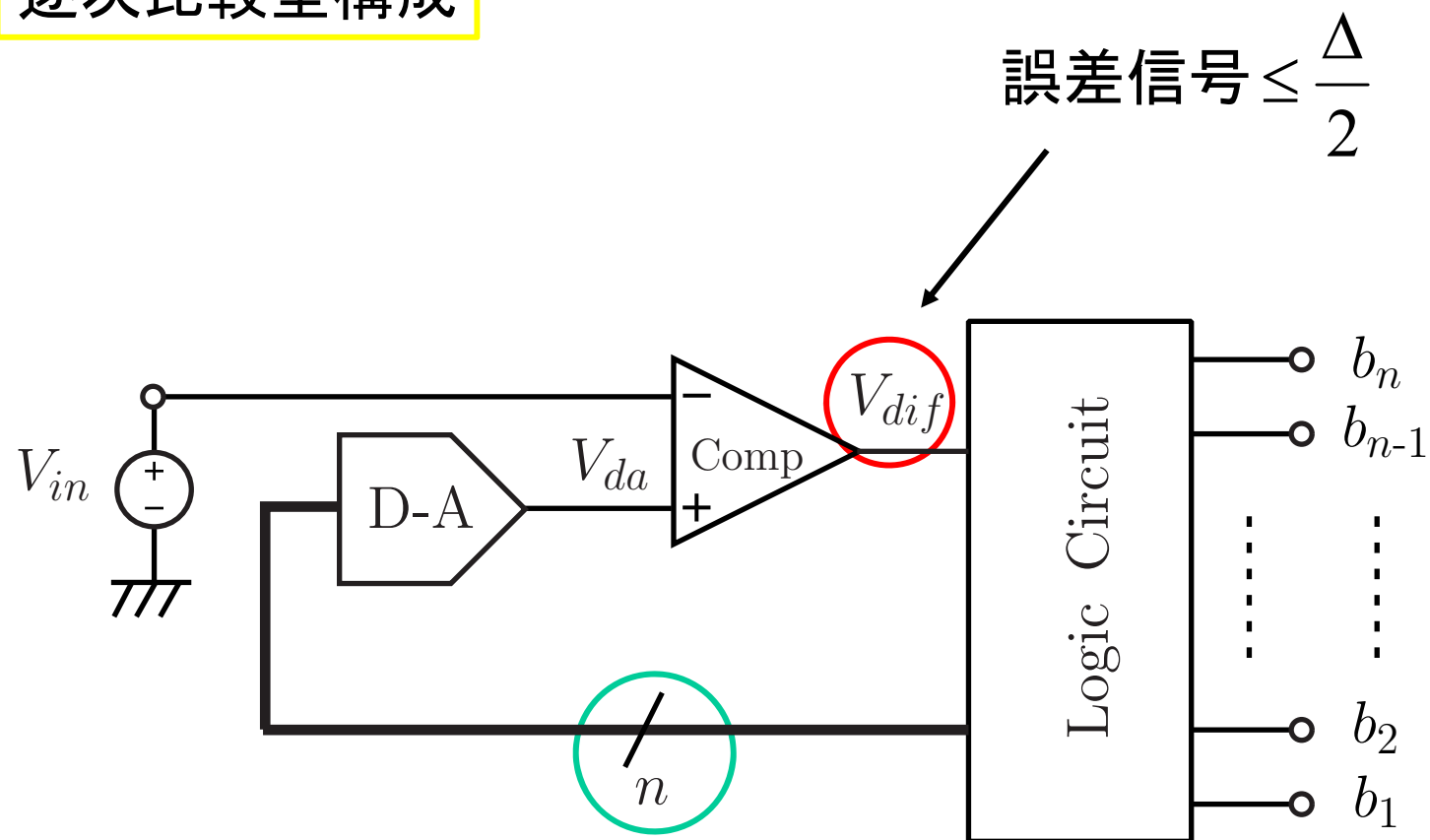


2進数

サーモメータコード

0111 → 0000000011111111

逐次比較型構成



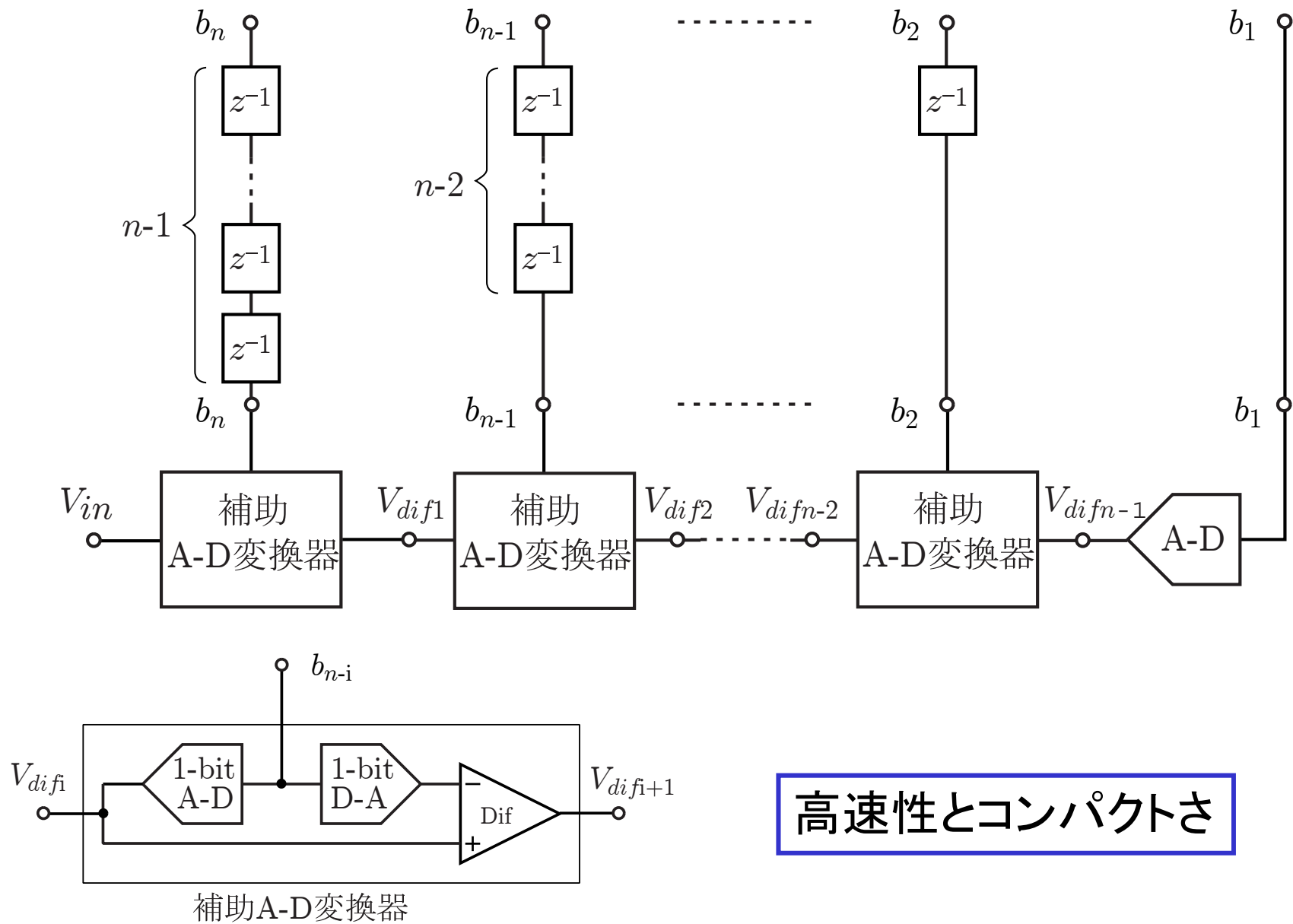
誤差信号 $\leq \frac{\Delta}{2}$

低速動作

n ビットのバス

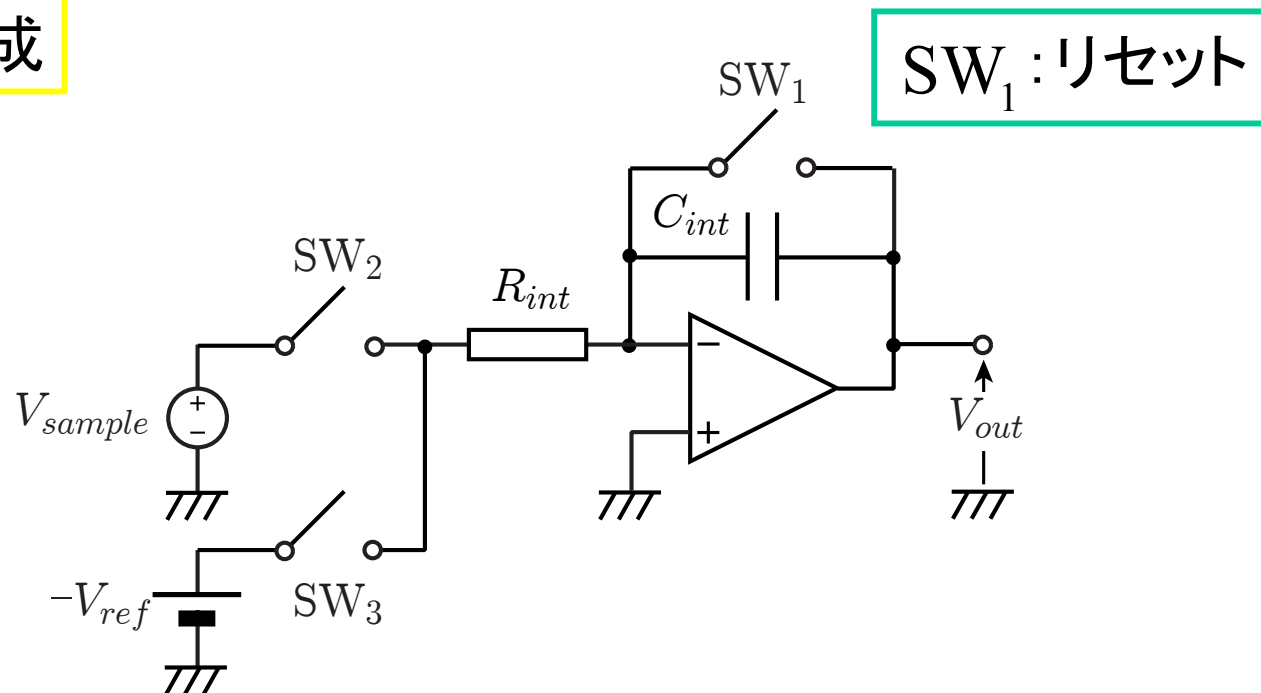
素子数のゆるやかな増加

パイプライン型A-D変換器



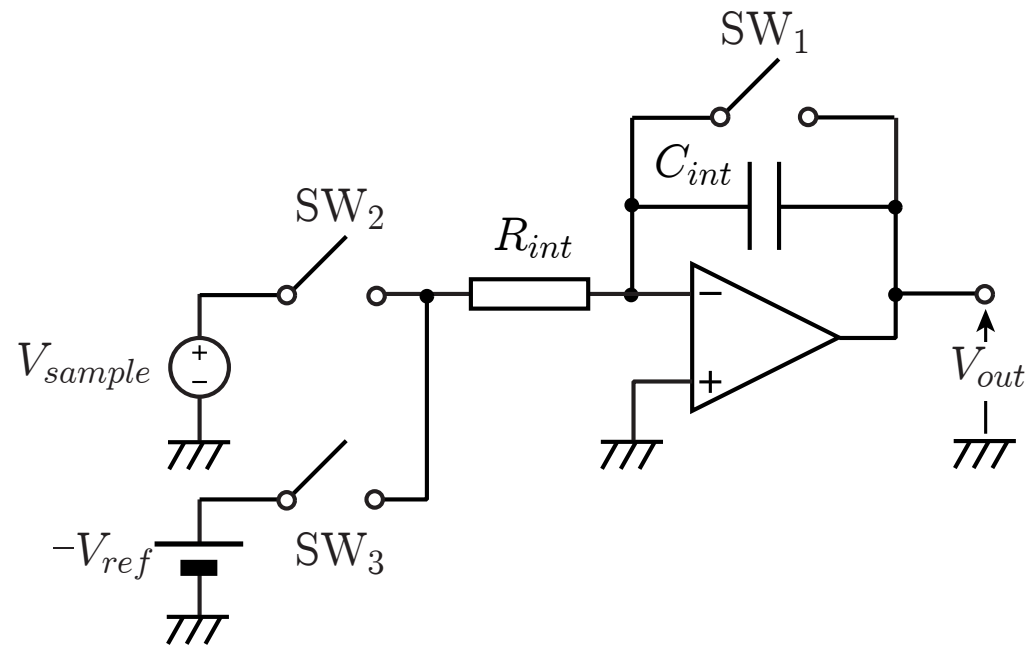
高速性とコンパクトさ

積分型構成



SW_2 : サンプルング

$$\begin{aligned} V_{out} &= - \int_0^{T_{conv}} \frac{1}{C_{int}} \cdot \frac{V_{sample}}{R_{int}} dt \\ &= - \frac{T_{conv} V_{sample}}{C_{int} R_{int}} \end{aligned}$$



SW₃ : 放電&計測

$$\begin{aligned}
 V_{out} &= -\frac{T_{conv} V_{sample}}{C_{int} R_{int}} \int_{T_{conv}}^t \frac{1}{C_{int}} \cdot \frac{-V_{ref}}{R_{int}} dt \\
 &= -\frac{T_{conv} V_{sample}}{C_{int} R_{int}} + \frac{V_{ref}}{C_{int} R_{int}} t
 \end{aligned}$$

$$V_{out} = -\frac{T_{conv}V_{sample}}{C_{int}R_{int}} + \frac{V_{ref}}{C_{int}R_{int}}t_{crit} = 0$$

↑

コンパレータの出力反転により検知

$$V_{sample} = \frac{t_{crit}}{T_{conv}}V_{ref}$$

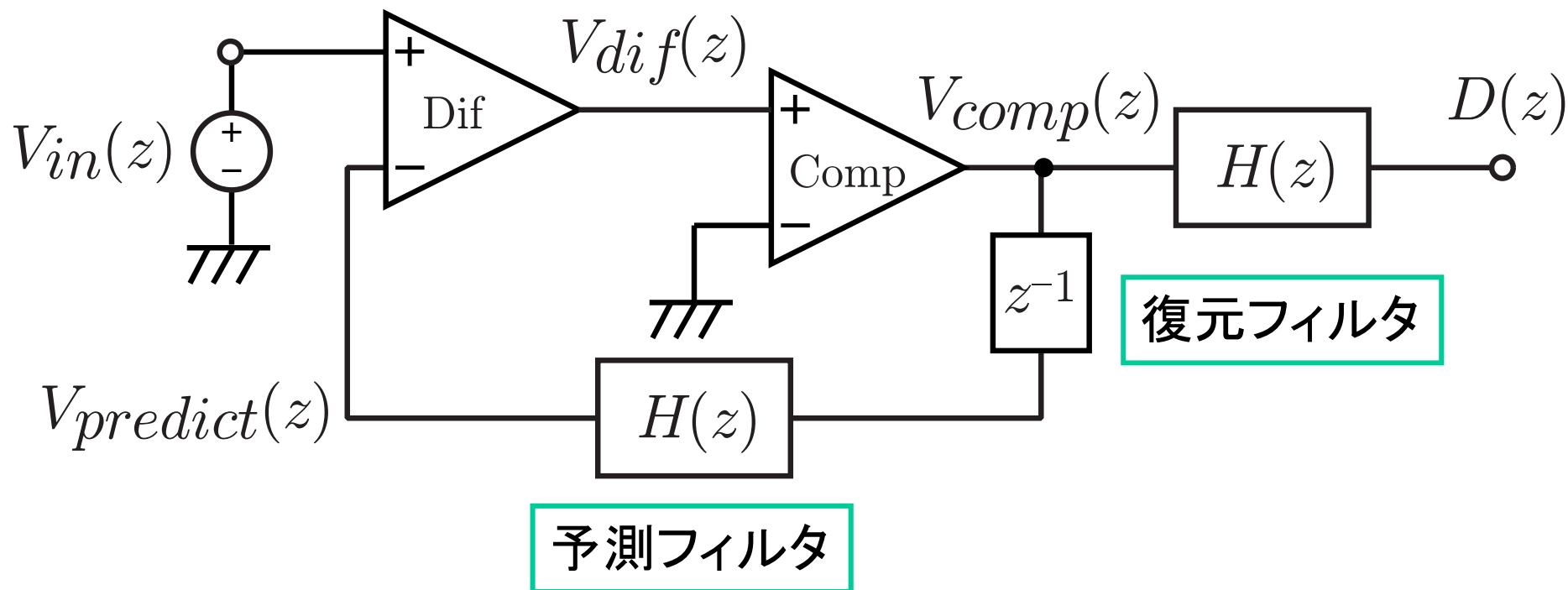
精度＝時間測定の正確さ



高精度

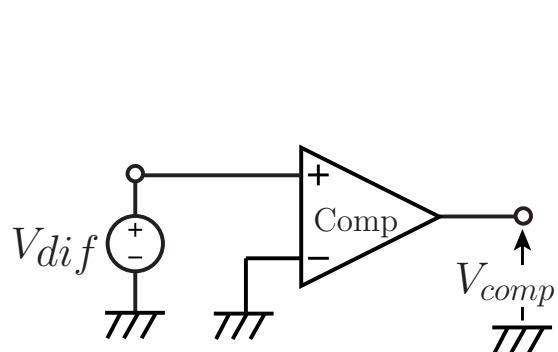
Δ - Σ 変調型構成

Δ 変調型構成

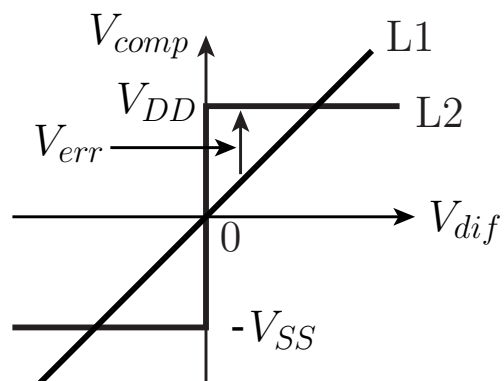


$V_{dif}(z) = V_{in}(z) - V_{predict}(z)$ により次の $V_{in}(z)$ を予測

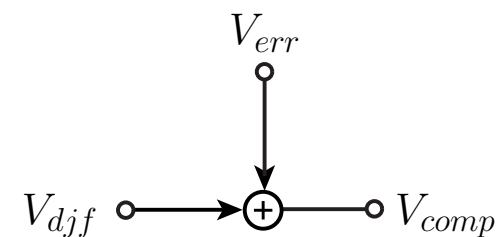
比較器のモデリング



(a)

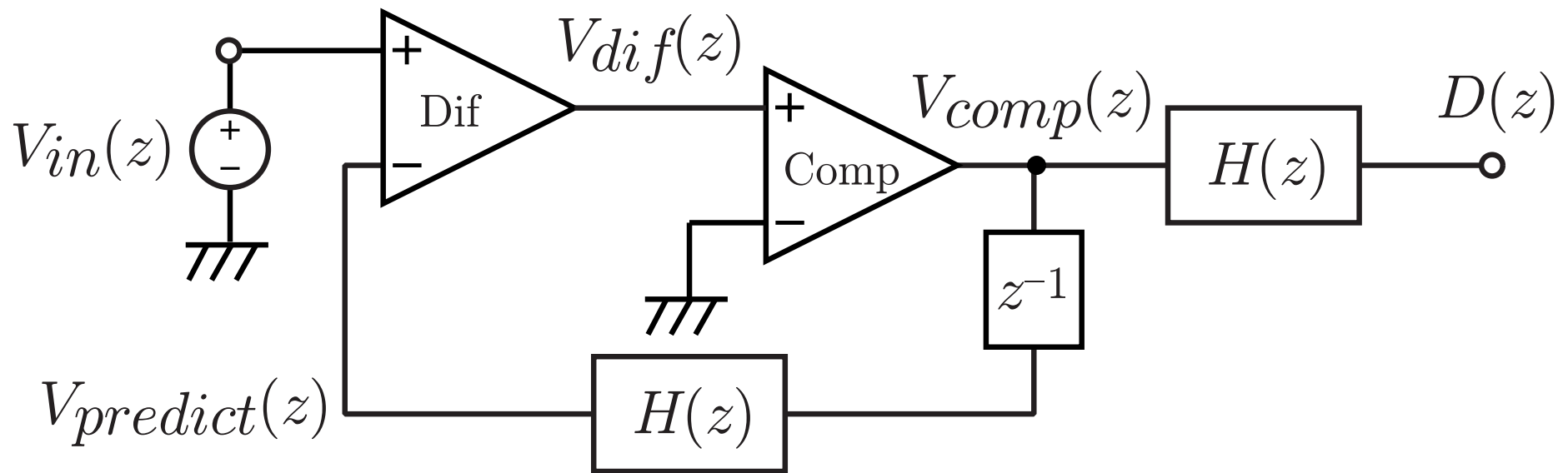


(b)



(c)

コンパレータ: 非線形素子 → 線形素子 + 雑音

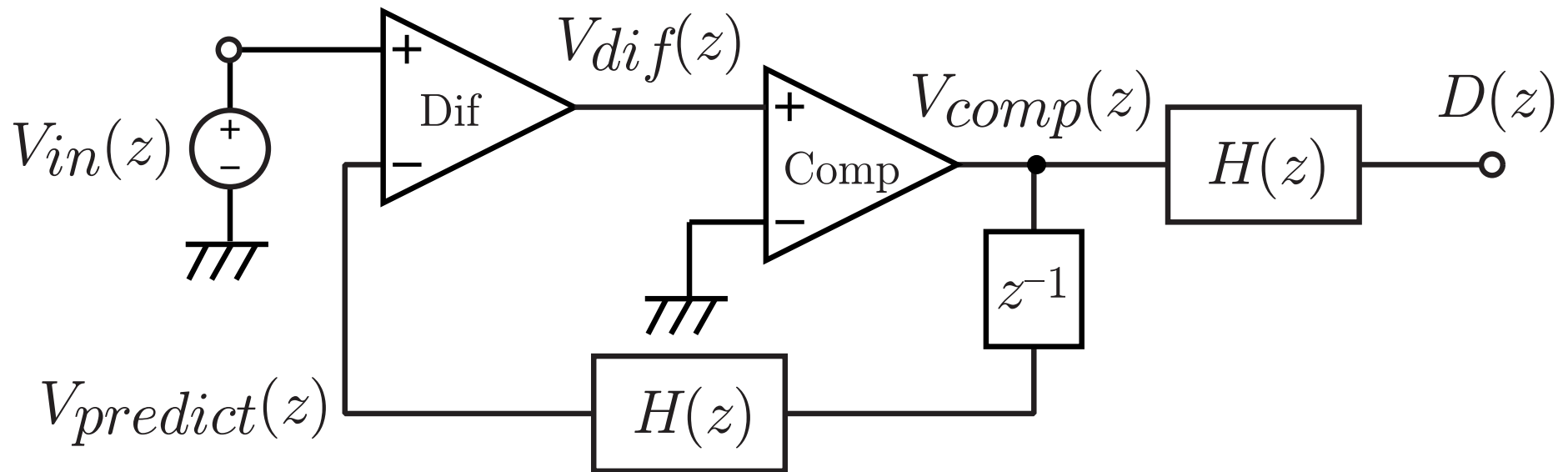


$$V_{comp}(z) = V_{dif}(z) + V_{err}(z)$$

$$= V_{in}(z) - V_{predict}(z) + V_{err}(z)$$

$$= V_{in}(z) - z^{-1}H(z)V_{comp}(z) + V_{err}(z)$$

$$V_{comp}(z) = \frac{V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1}H(z)}$$



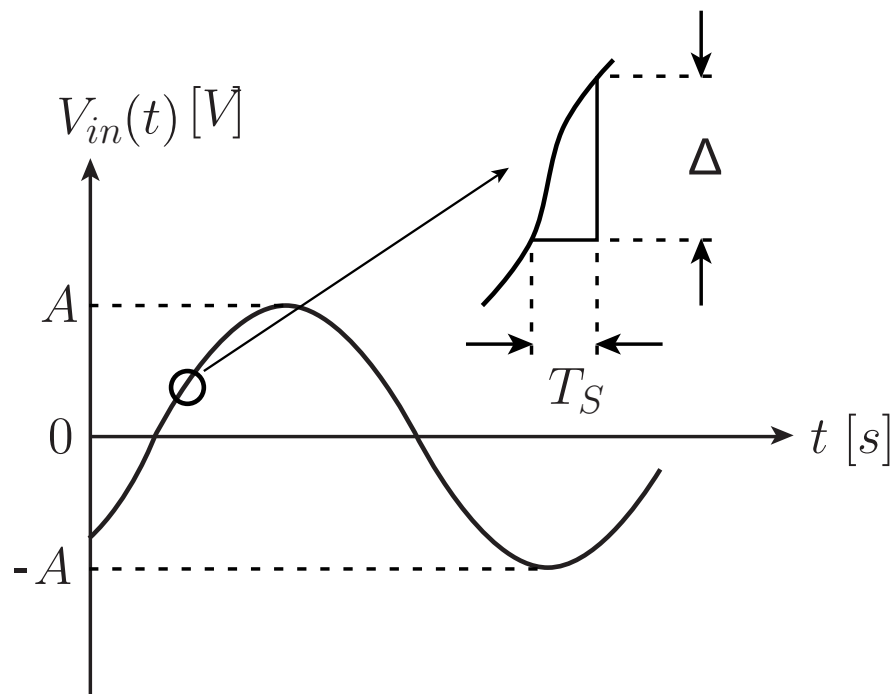
$$V_{comp}(z) = \frac{V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1}H(z)}$$

$$\longrightarrow D(z) = H(z)V_{comp}(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1} \frac{1}{1 - z^{-1}}} \\ &= V_{in}(z) + V_{err}(z) \end{aligned}$$

傾斜負荷



$$V_{in}(t) = A \sin(2\pi f_{max} t + \theta)$$

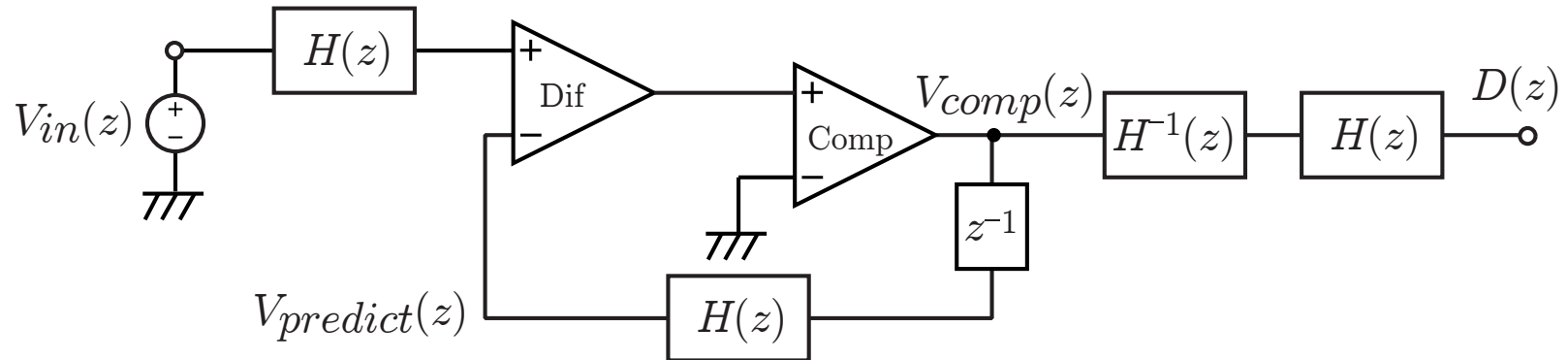
f_{max} : 最大信号周波数

Δ : 比較器の出力変化幅

T_s : サンプルング間隔

$$\max \left[\frac{dV_{in}(t)}{dt} \right] = \left. \frac{dV_{in}(t)}{dt} \right|_{V_{in}(t)=0} = 2\pi f_{max} A \leq \frac{\Delta}{T_s}$$

Δ-Σ変調型構成の原理



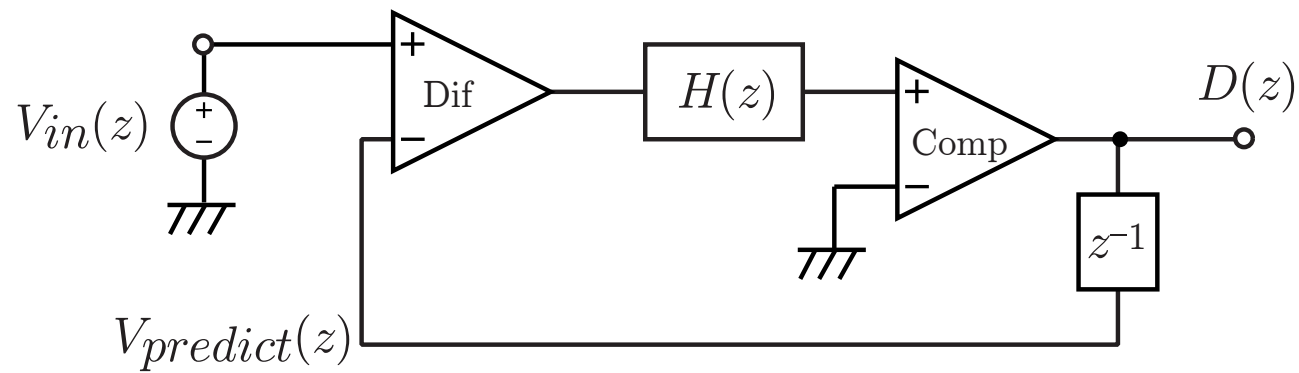
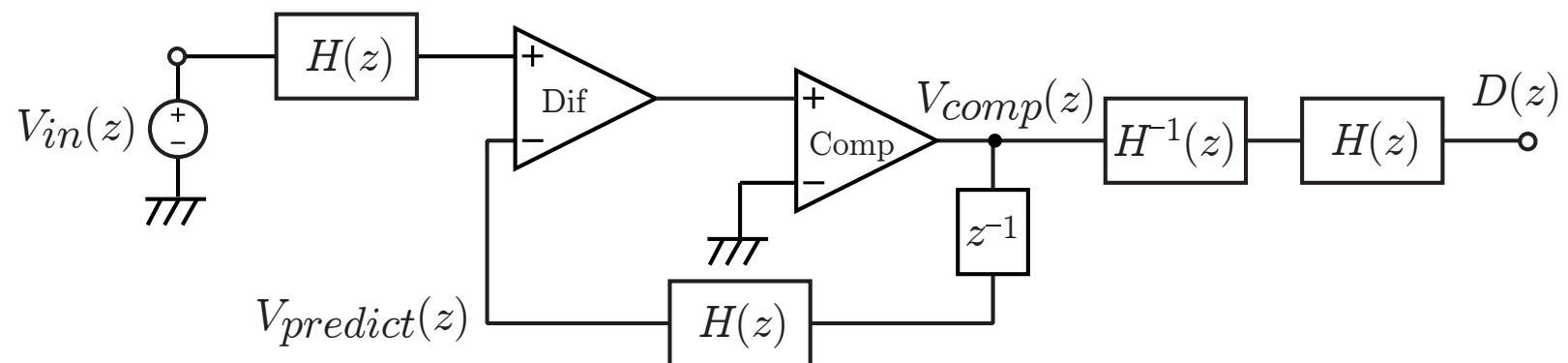
$$V_{in}(t) = A \sin(2\pi f_{max} t + \theta)$$

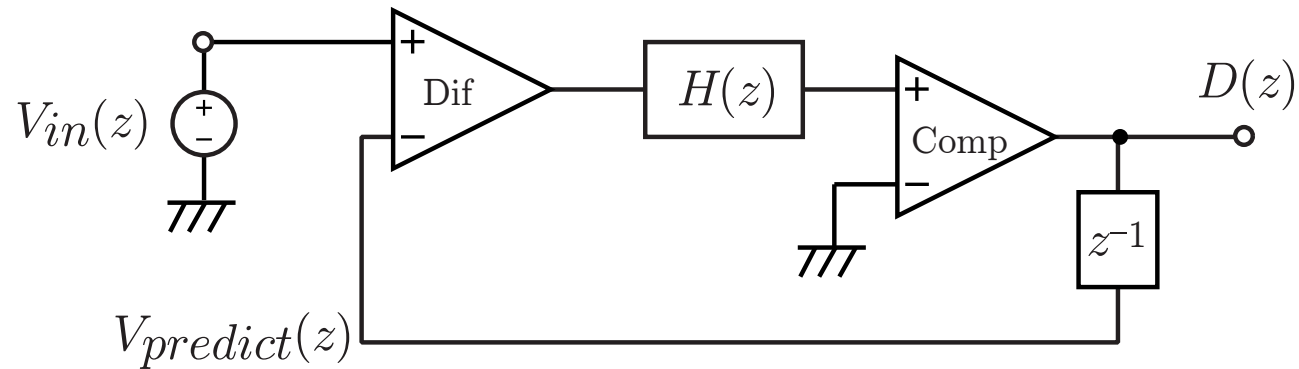
$H(z)$: 積分回路

$$V_{out}(t) = \frac{-A}{2\pi f_{max}} \cos(2\pi f_{max} t + \theta)$$

$$\text{最大傾斜} : \max \left[\frac{dV_{out}(t)}{dt} \right] = A$$

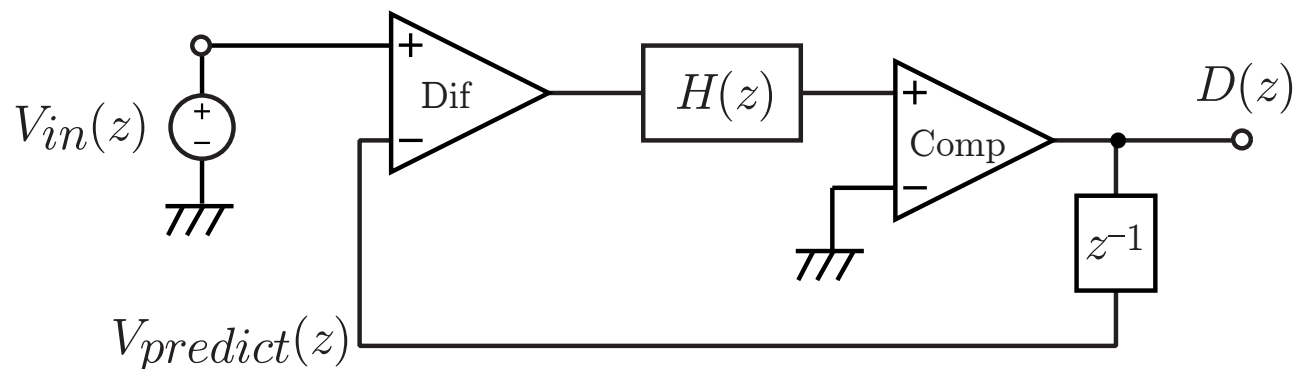
Δ - Σ 変調型構成の簡略化





$$\begin{aligned}
 D(z) &= V_{comp}(z) \\
 &= H(z) \{ V_{in}(z) - V_{predict}(z) \} + V_{err}(z) \\
 &= H(z) V_{in}(z) - z^{-1} H(z) D(z) + V_{err}(z)
 \end{aligned}$$

$$D(z) = \frac{H(z) V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1} H(z)}$$



Δ - Σ 変調

Δ 変調

$$D(z) = \frac{H(z)V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1}H(z)}$$

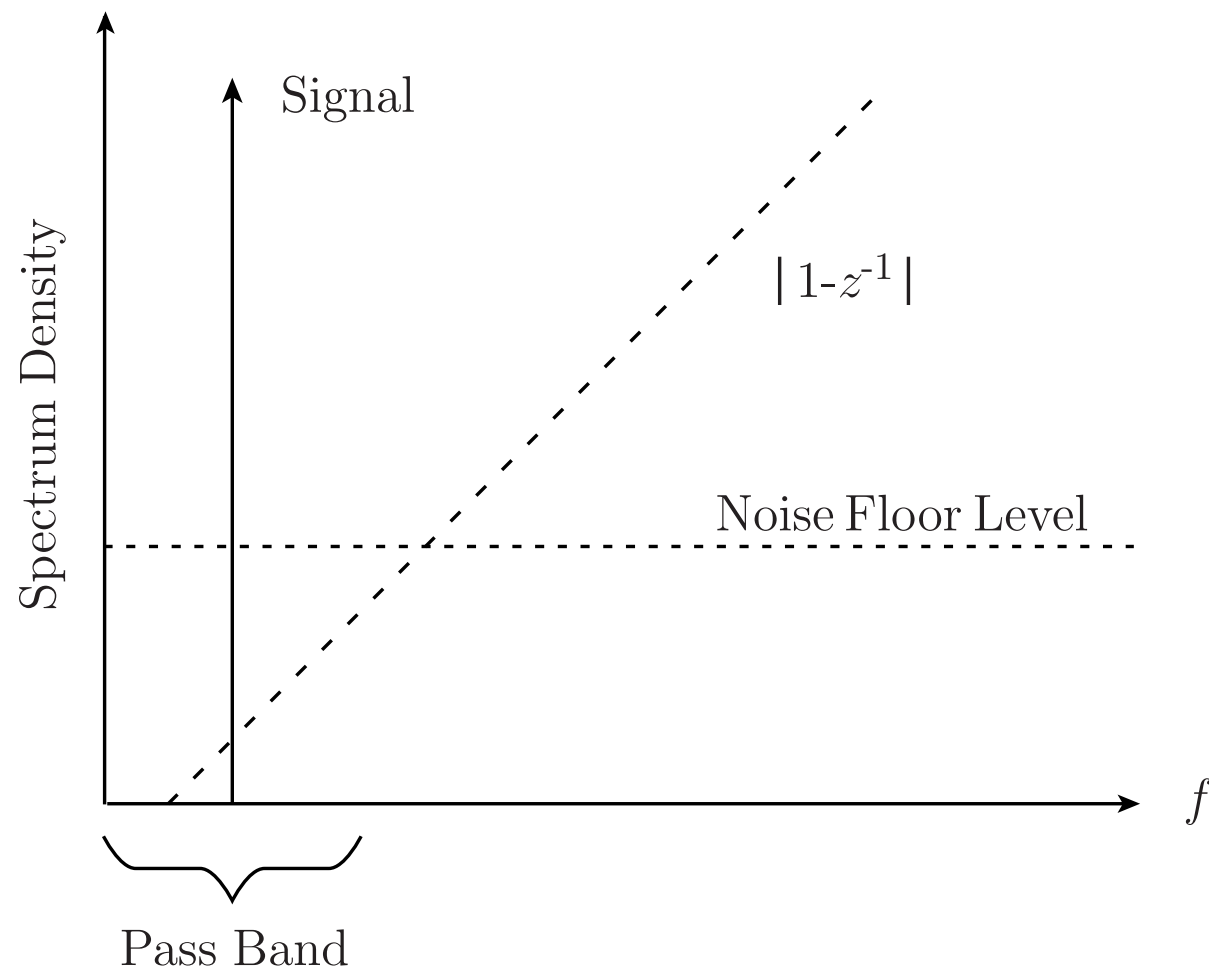


$$D(z) = H(z) \frac{V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1}H(z)}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$D(z) = \frac{\frac{1}{1 - z^{-1}} V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1} \frac{1}{1 - z^{-1}}} = V_{in}(z) + (1 - z^{-1})V_{err}(z)$$

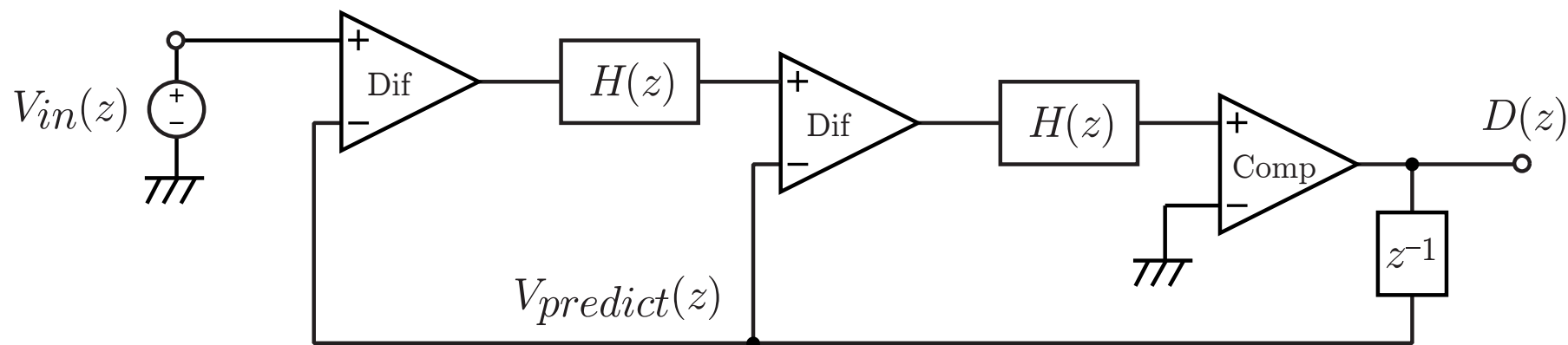
$$D(z) = V_{in}(z) + (1 - z^{-1})V_{err}(z)$$



帯域内雑音の低減

高次 Δ - Σ 変調型構成

高次=不安定!?



$$D(z) = \frac{H^2(z)V_{in}(z) + V_{err}(z)}{1 + z^{-1}H(z) + z^{-1}H^2(z)}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$D(z) = V_{in}(z) + (1 - z^{-1})^2 V_{err}(z)$$